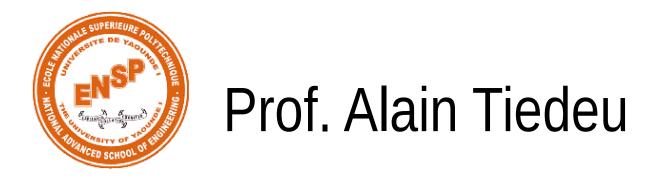


Enseignes et afficheurs à LED

La diode à jonction : principes physiques



La diode à jonction : principes physiques



Prof. Alain Tiedeu

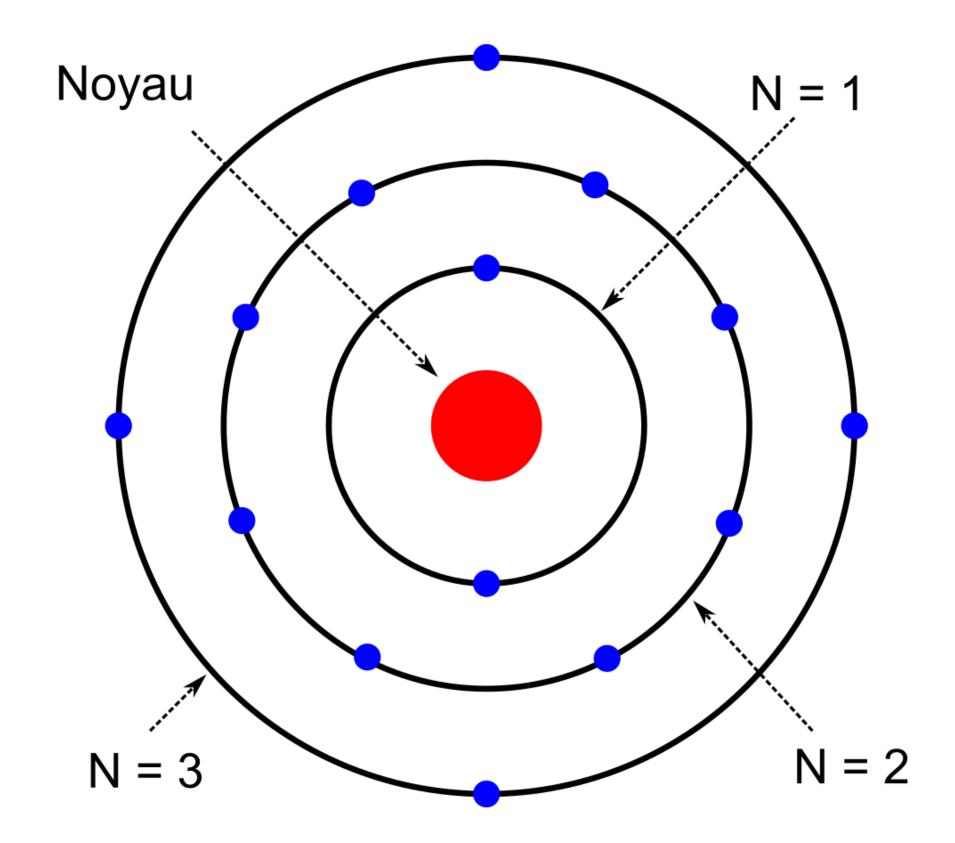
La diode à jonction : principes physiques



- Modèle de Bohr
- Niveaux d'énergie
- Semi-conducteurs intrinsèques
- Dopage N et P
- Jonction PN
- La diode à jonction

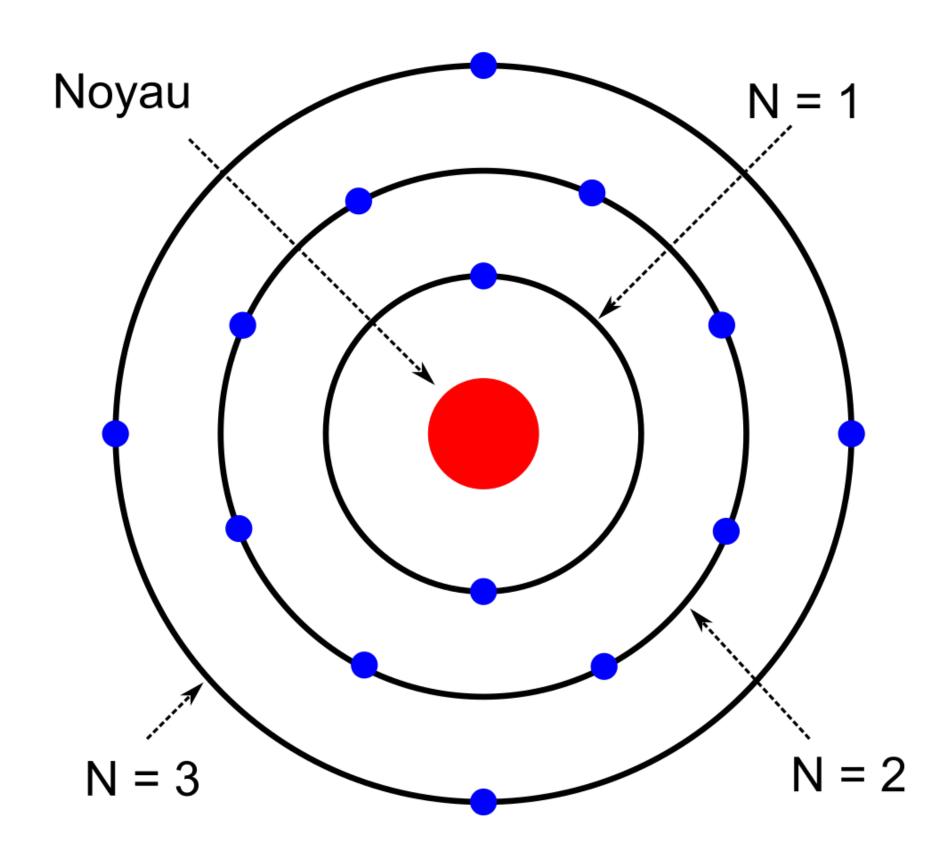


Noyau central



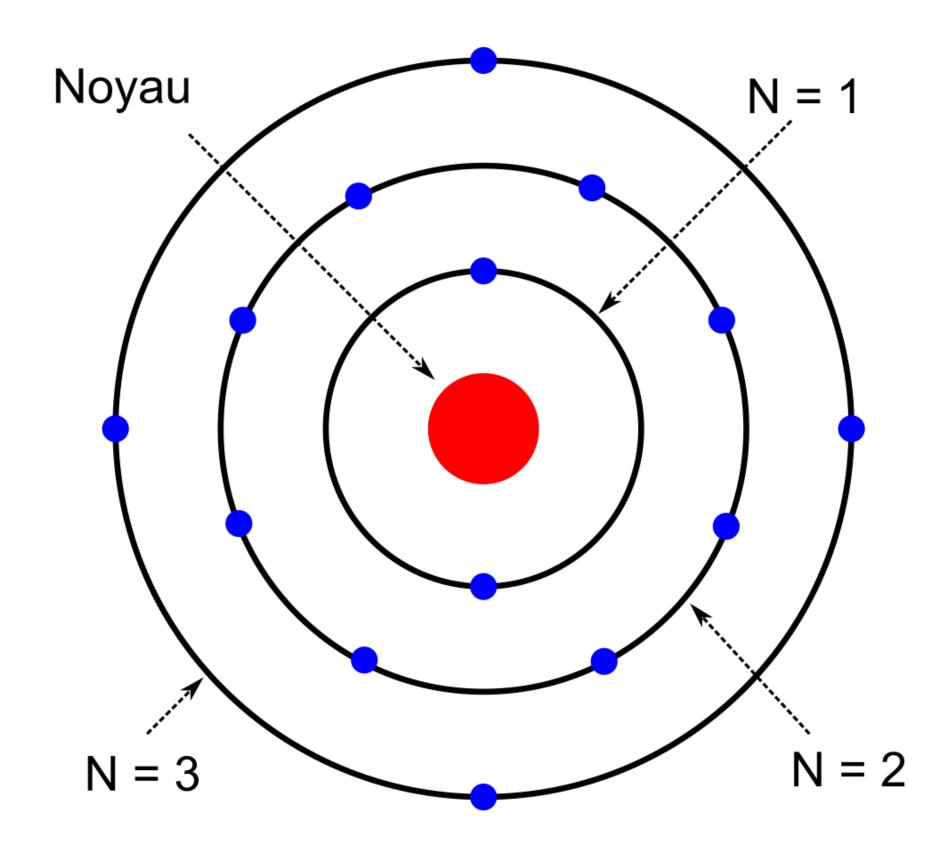


- Noyau central
- Électrons sur trajectoires circulaires formant des couches autour du noyau



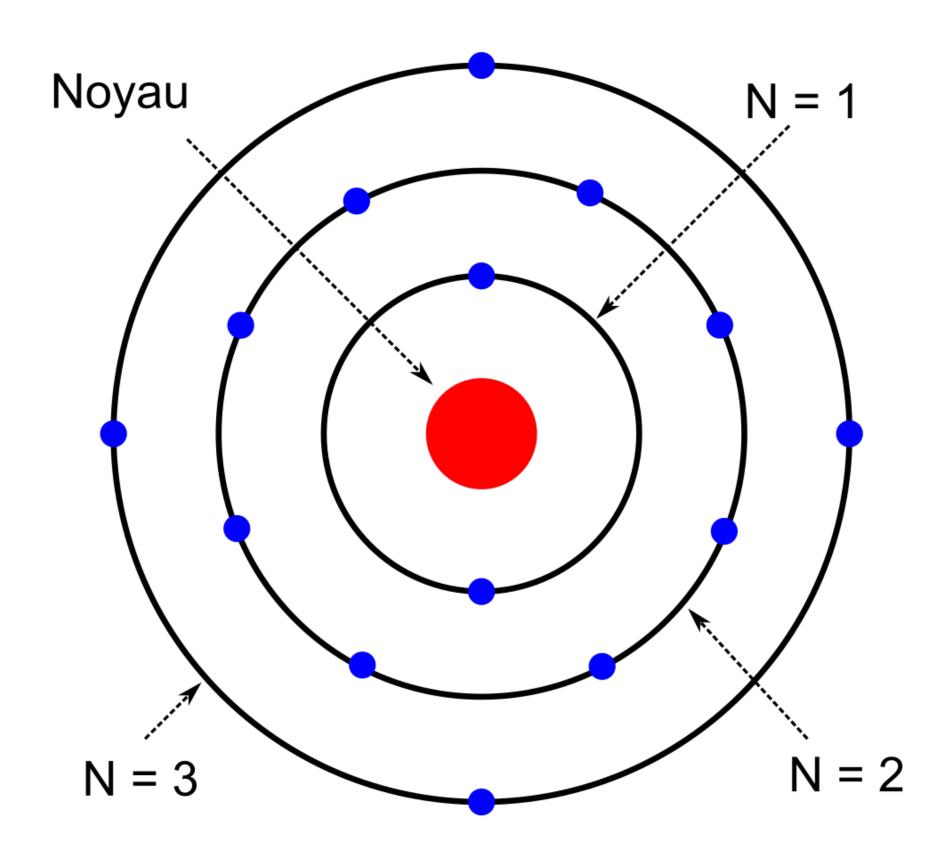


- Noyau central
- Électrons sur trajectoires circulaires formant des couches autour du noyau
- Nombre maximal d'électrons sur une couche de numéro n = 2n²



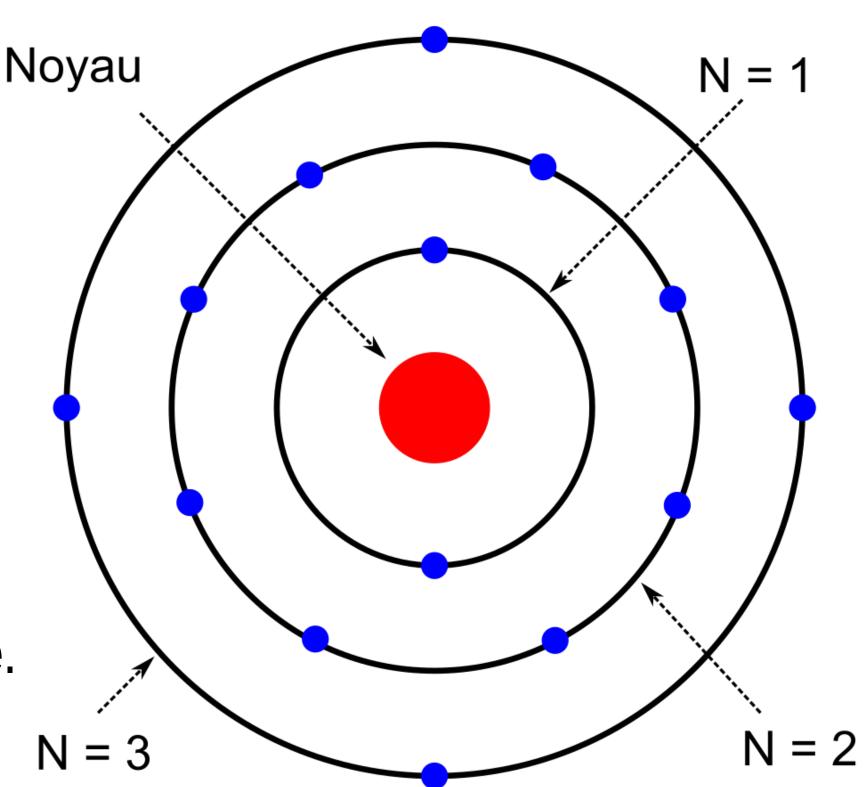


- Noyau central
- Électrons sur trajectoires circulaires formant des couches autour du noyau
- Nombre maximal d'électrons sur une couche de numéro n = 2n²
- Distribution des électrons de l'intérieur vers l'extérieur (n croissant)



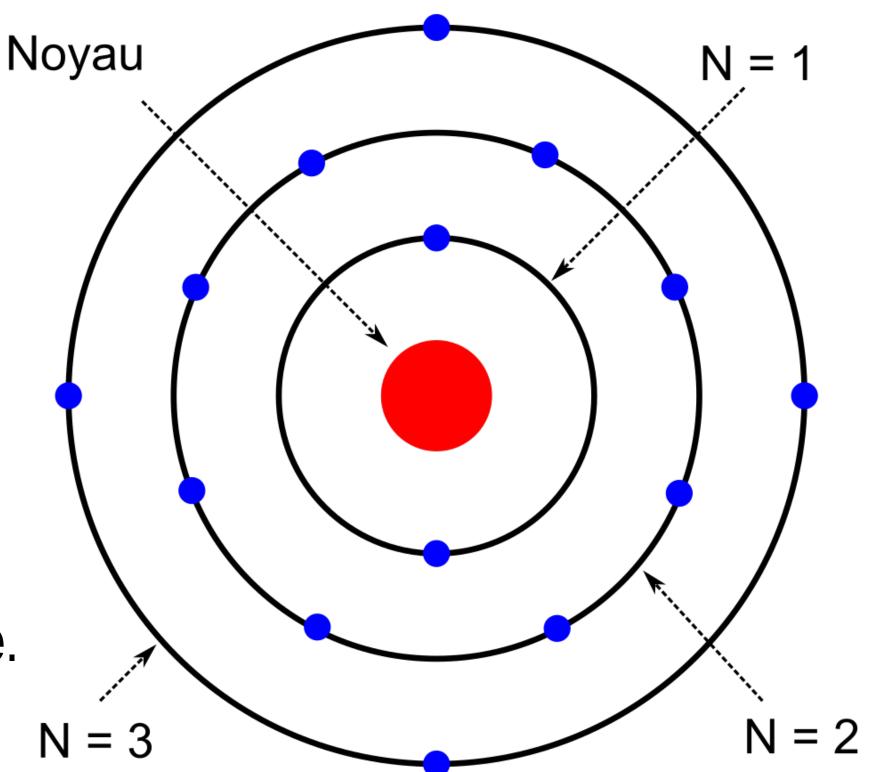


- Noyau central
- Électrons sur trajectoires circulaires formant des couches autour du noyau
- Nombre maximal d'électrons sur une couche de numéro n = 2n²
- Distribution des électrons de l'intérieur vers l'extérieur (n croissant)
- Couche la plus externe est appelée couche de valence.
 Elle contient les électrons qui participent aux liaisons





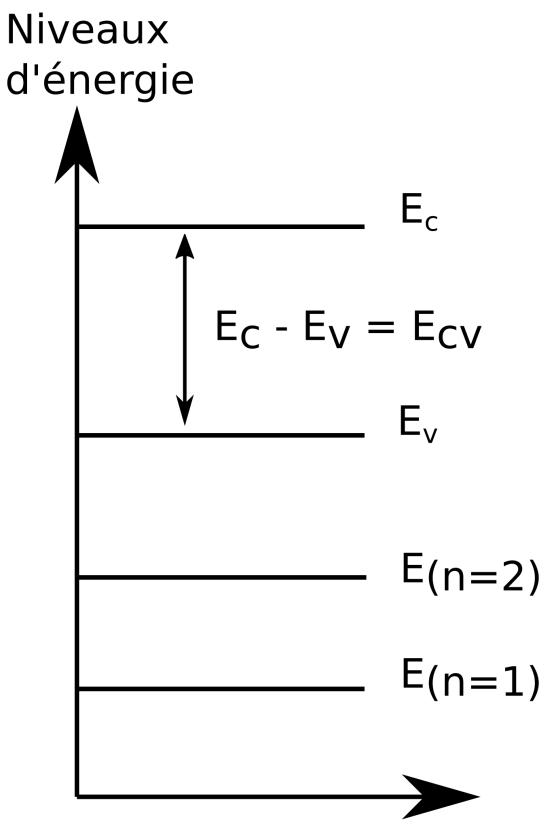
- Noyau central
- Électrons sur trajectoires circulaires formant des couches autour du noyau
- Nombre maximal d'électrons sur une couche de numéro n = 2n²
- Distribution des électrons de l'intérieur vers l'extérieur (n croissant)
- Couche la plus externe est appelée couche de valence. Elle contient les électrons qui participent aux liaisons



• Si électron quitte l'atome et devient libre, il passe dans la couche de conduction



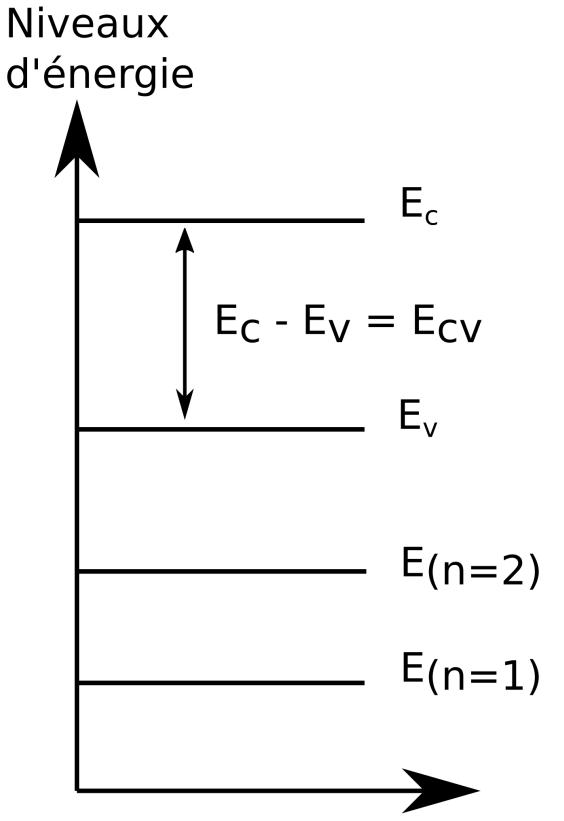
• Couche n correspond à un niveau d'énergie E_n



E_v: Energie de la couche de valence



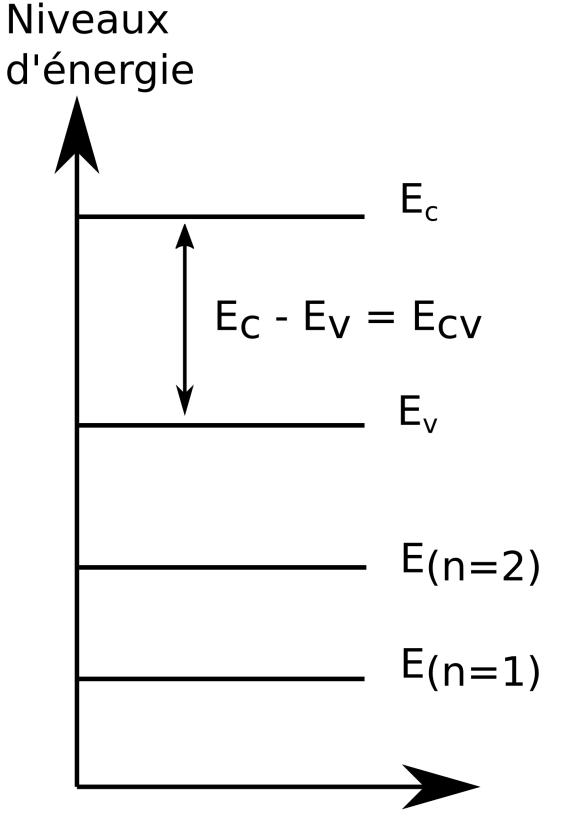
- Couche n correspond à un niveau d'énergie En
- Un électron passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur en recevant de l'énergie



E_v: Energie de la couche de valence



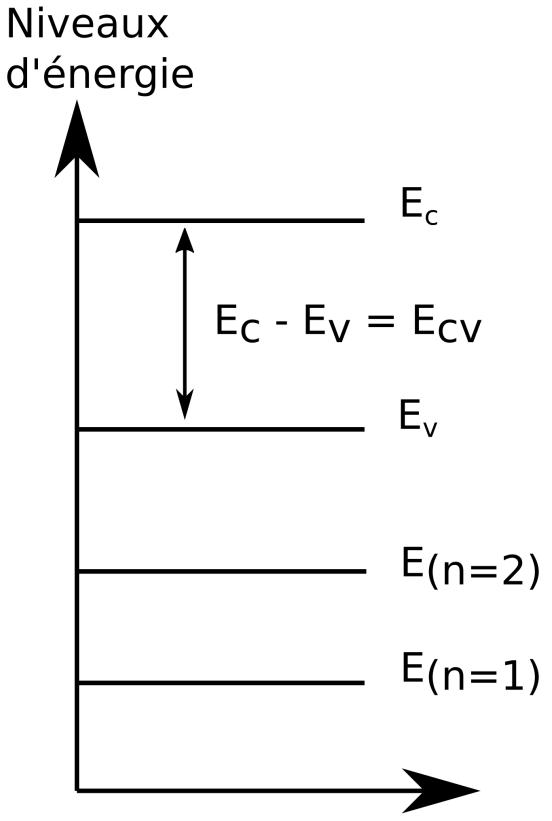
- Couche n correspond à un niveau d'énergie En
- Un électron passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur en recevant de l'énergie
- Il fait l'inverse en émettant de l'énergie



E_v: Energie de la couche de valence



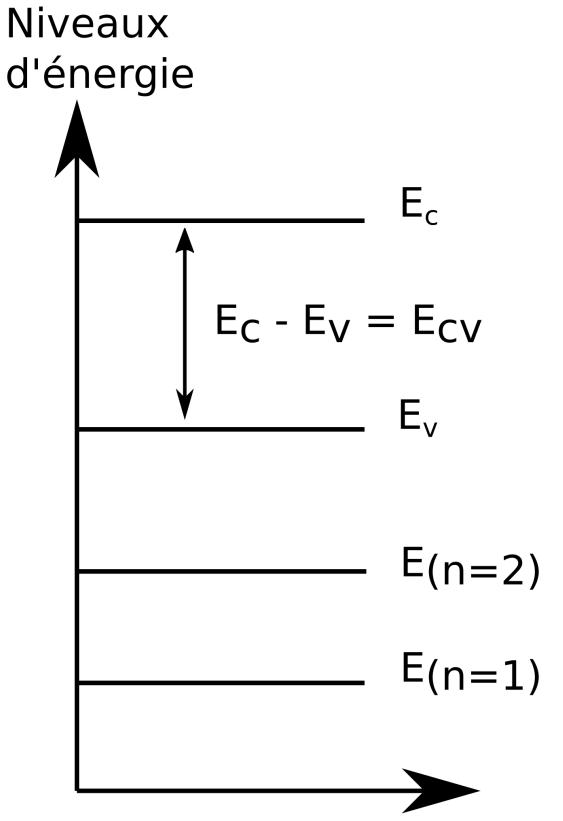
- Couche n correspond à un niveau d'énergie En
- Un électron passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur en recevant de l'énergie
- Il fait l'inverse en émettant de l'énergie
- Énergie émise ou énergie reçue est égale à la différence d'énergie entre les 2 niveaux



E_v: Energie de la couche de valence



- Couche n correspond à un niveau d'énergie E_n
- Un électron passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur en recevant de l'énergie
- Il fait l'inverse en émettant de l'énergie
- Énergie émise ou énergie reçue est égale à la différence d'énergie entre les 2 niveaux
- Énergie peut être émise par l'électron ou donnée à l'électron sous plusieurs formes



E_v: Energie de la couche de valence



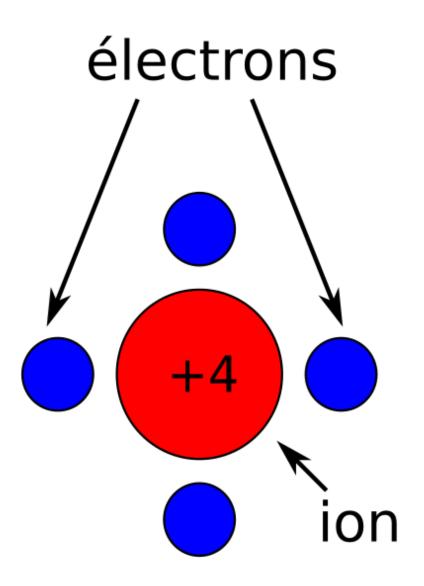
• Elément de la colonne IV du tableau de classification périodique des éléments



- Elément de la colonne IV du tableau de classification périodique des éléments
- Intrinsèque = à l'état « pur »

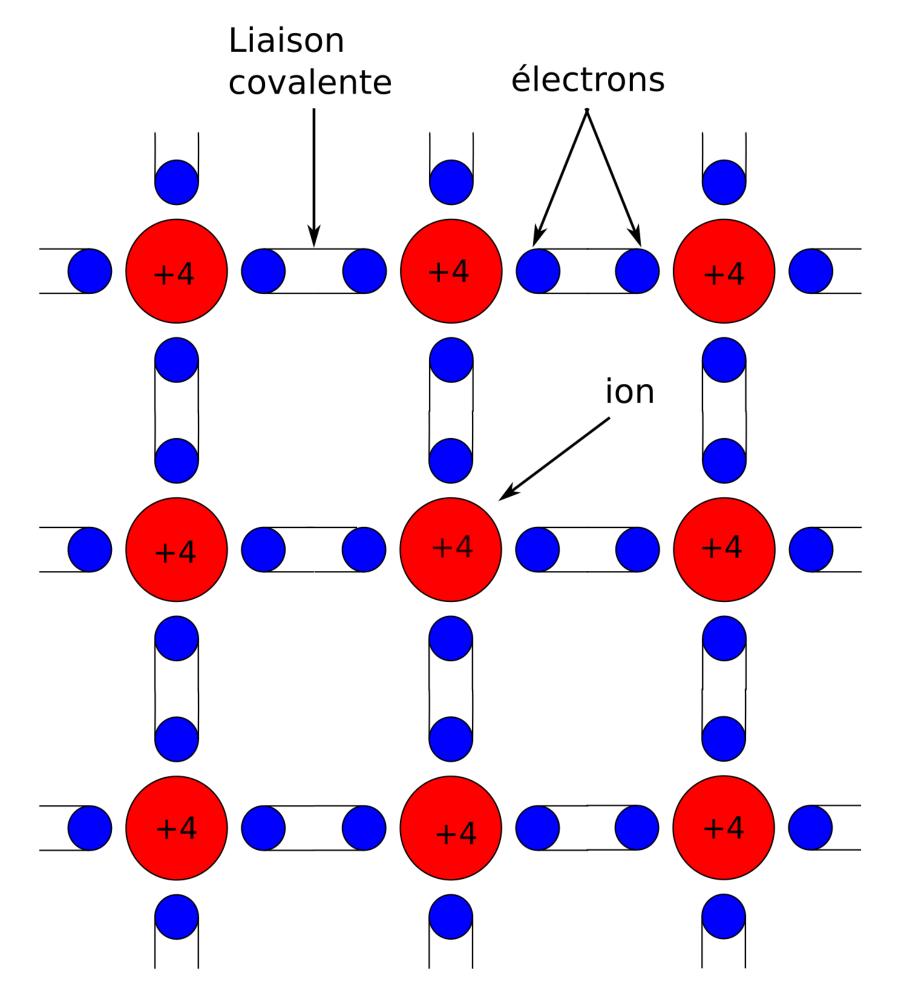


- Elément de la colonne IV du tableau de classification périodique des éléments
- Intrinsèque = à l'état « pur »
- 4 électrons de valence



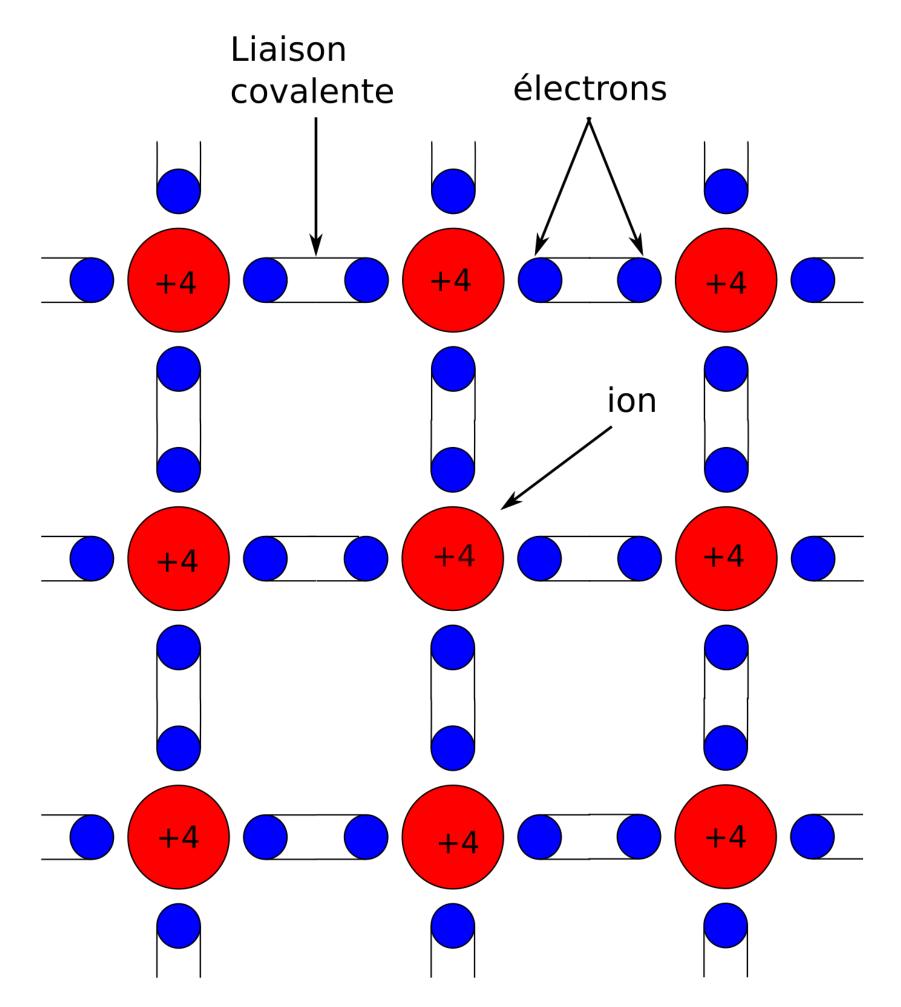


- Elément de la colonne IV du tableau de classification périodique des éléments
- Intrinsèque = à l'état « pur »
- 4 électrons de valence
- Dans le cristal, les 4 électrons sont engagés dans des liaisons covalentes avec les 4 voisins



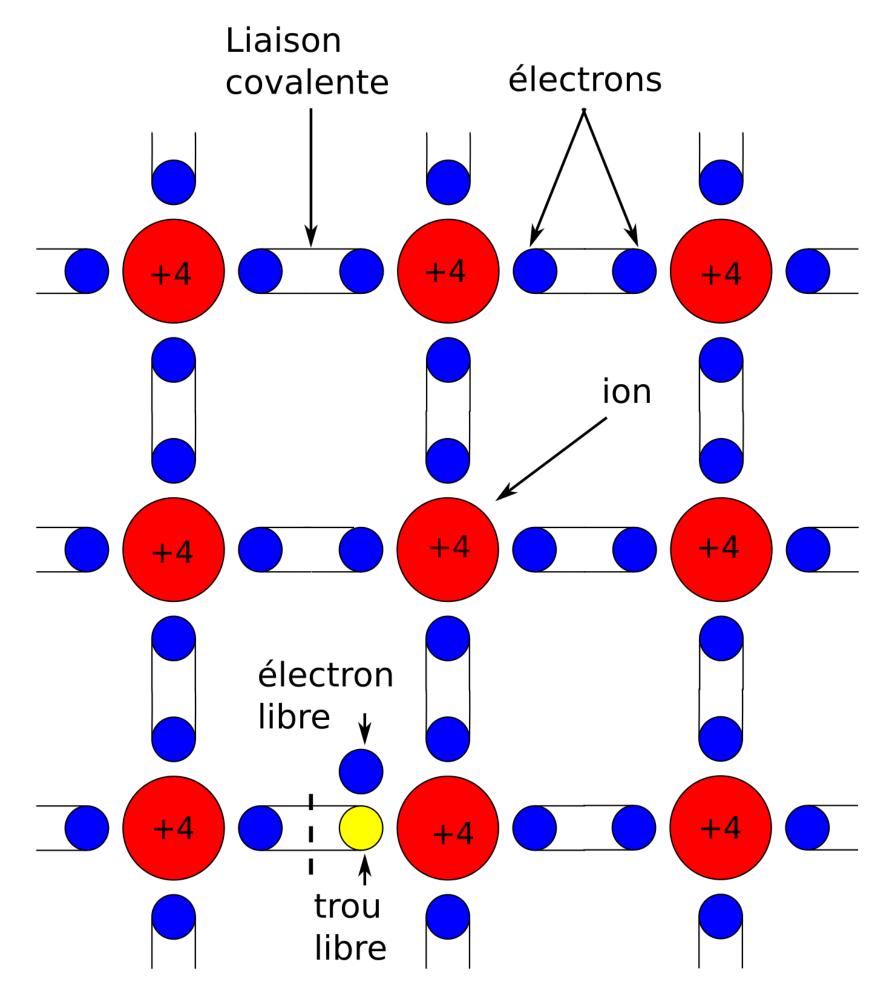


- Elément de la colonne IV du tableau de classification périodique des éléments
- Intrinsèque = à l'état « pur »
- 4 électrons de valence
- Dans le cristal, les 4 électrons sont engagés dans des liaisons covalentes avec les 4 voisins
- Il n'y a donc pas d'électron libre et par conséquent pas de courant électrique



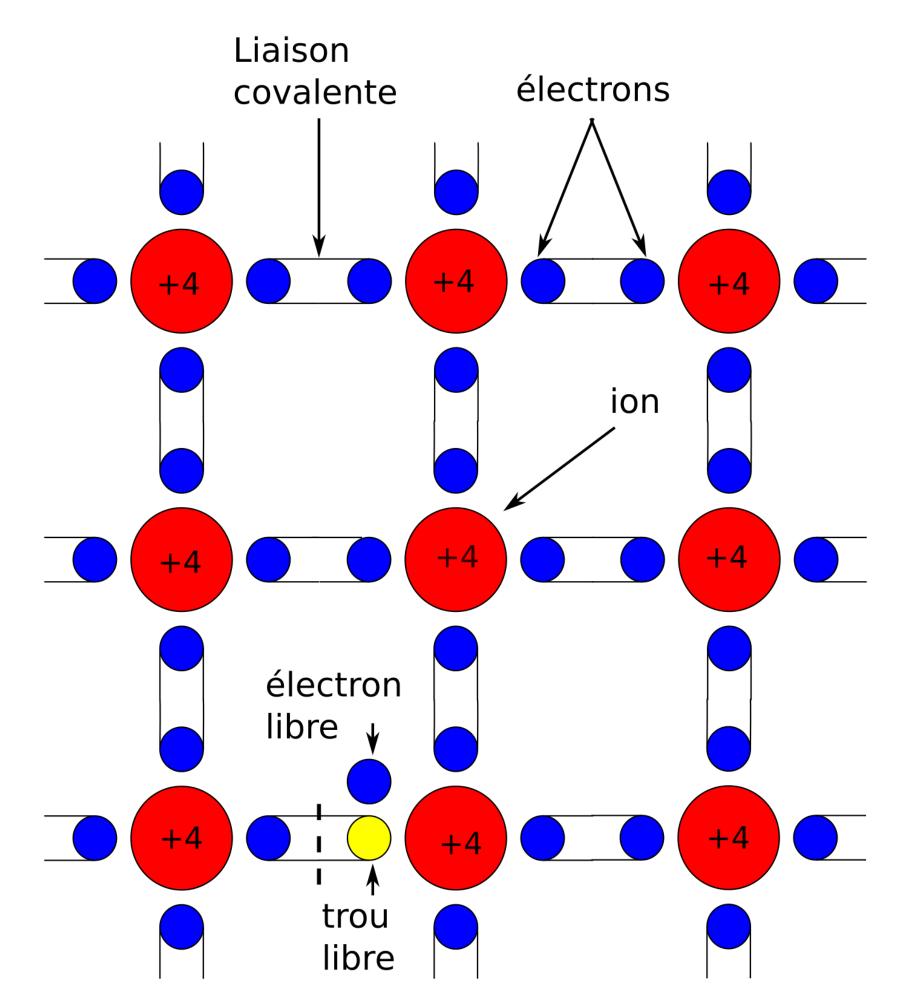


• Communiquer de l'énergie à l'atome par un moyen quelconque (lumière, élévation de la température, etc...)



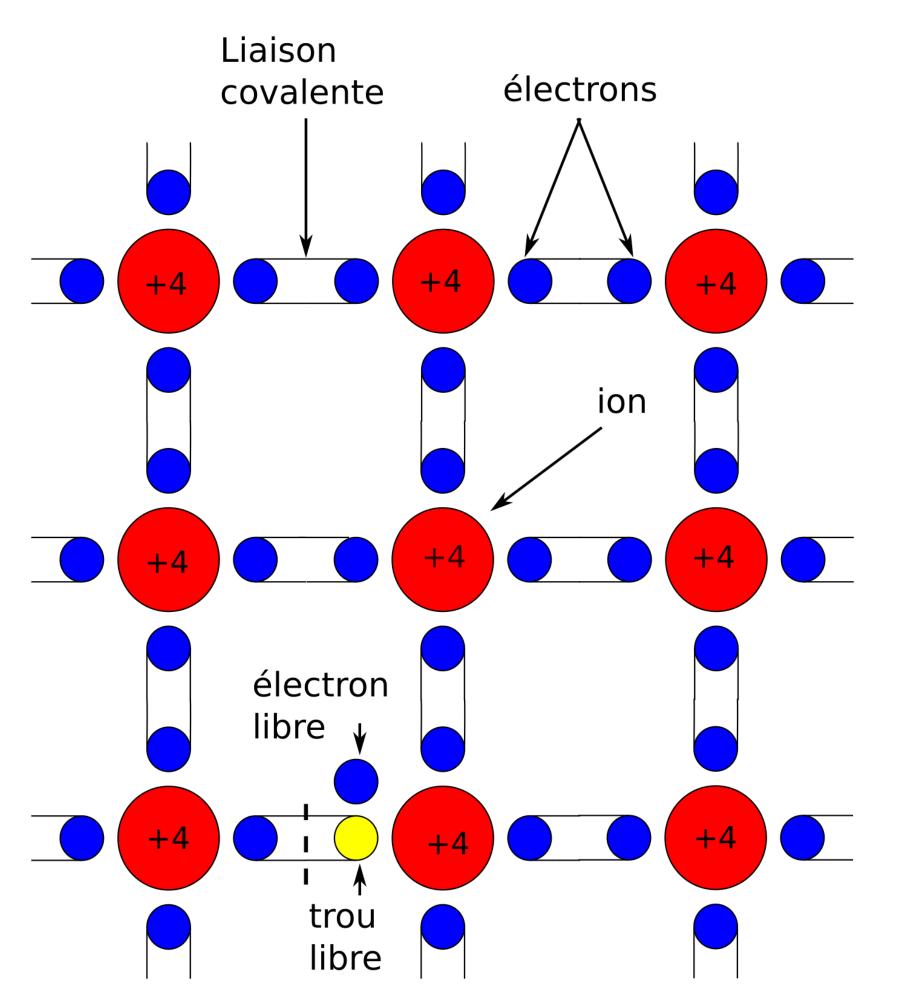


- Communiquer de l'énergie à l'atome par un moyen quelconque (lumière, élévation de la température, etc...)
- Électrons de couche de valence s'en échappent, passent dans la couche de conduction et deviennent **libres**



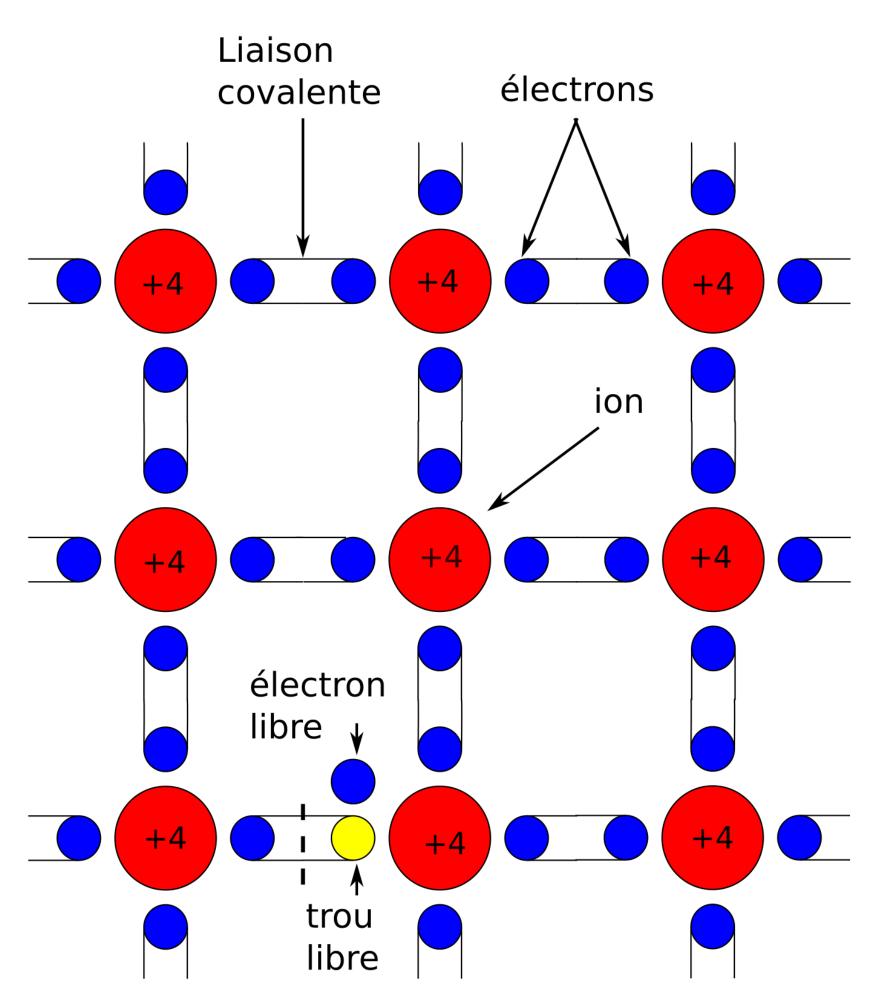


- Communiquer de l'énergie à l'atome par un moyen quelconque (lumière, élévation de la température, etc...)
- Électrons de couche de valence s'en échappent, passent dans la couche de conduction et deviennent **libres**
- Leur départ laisse une charge positive de même valeur absolue appelée **trou**



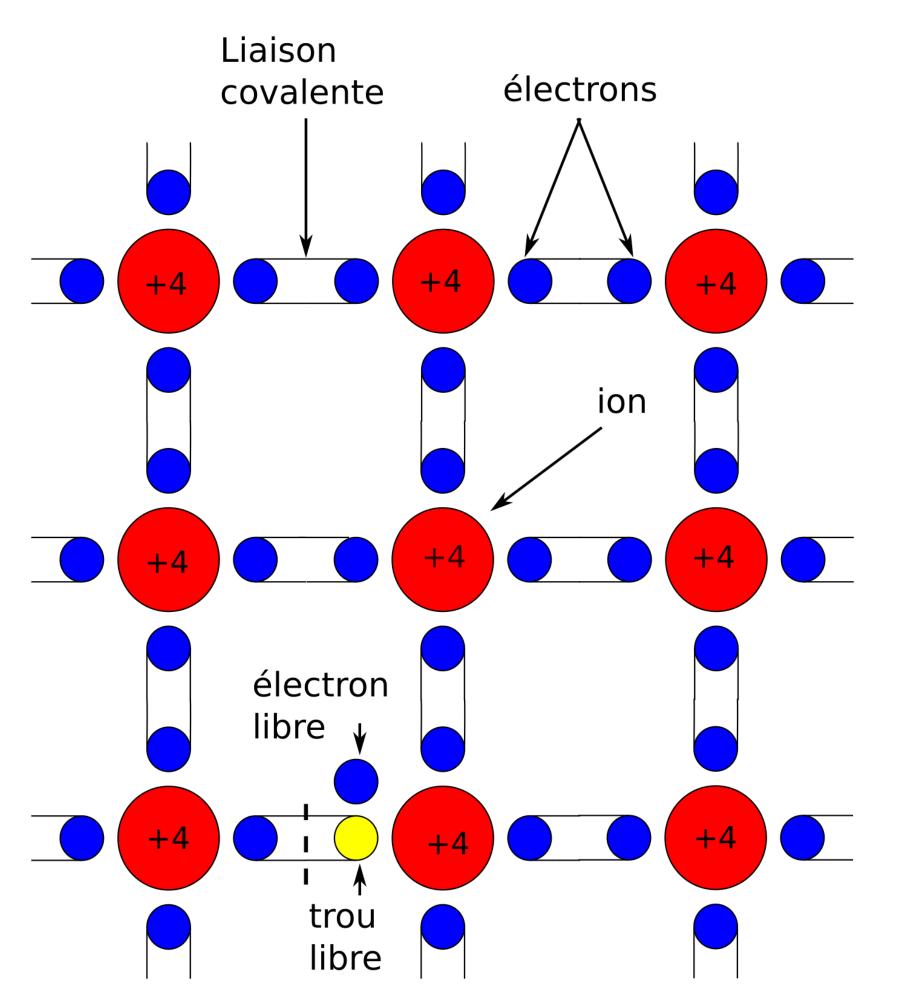


- Communiquer de l'énergie à l'atome par un moyen quelconque (lumière, élévation de la température, etc...)
- Électrons de couche de valence s'en échappent, passent dans la couche de conduction et deviennent **libres**
- Leur départ laisse une charge positive de même valeur absolue appelée **trou**
- Une paire électron-trou libre est née!



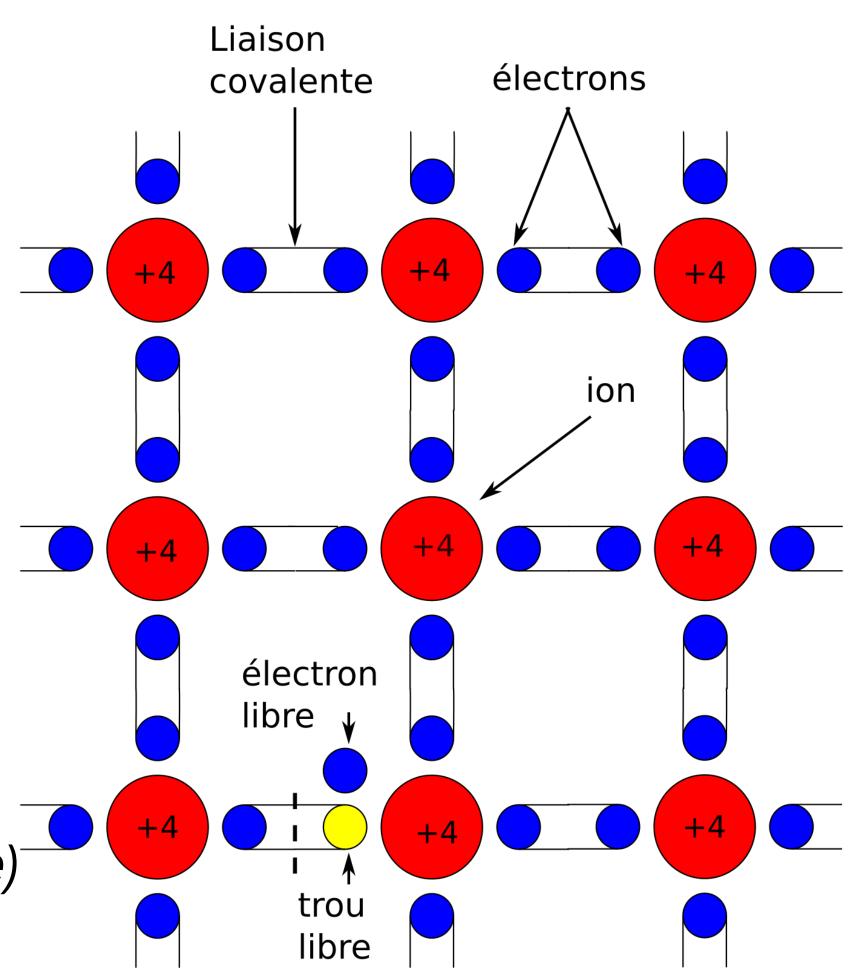


- Communiquer de l'énergie à l'atome par un moyen quelconque (lumière, élévation de la température, etc...)
- Électrons de couche de valence s'en échappent, passent dans la couche de conduction et deviennent **libres**
- Leur départ laisse une charge positive de même valeur absolue appelée **trou**
- Une paire électron-trou libre est née!
- Charges positives et négatives se déplacent et créent un courant électrique dans le cristal



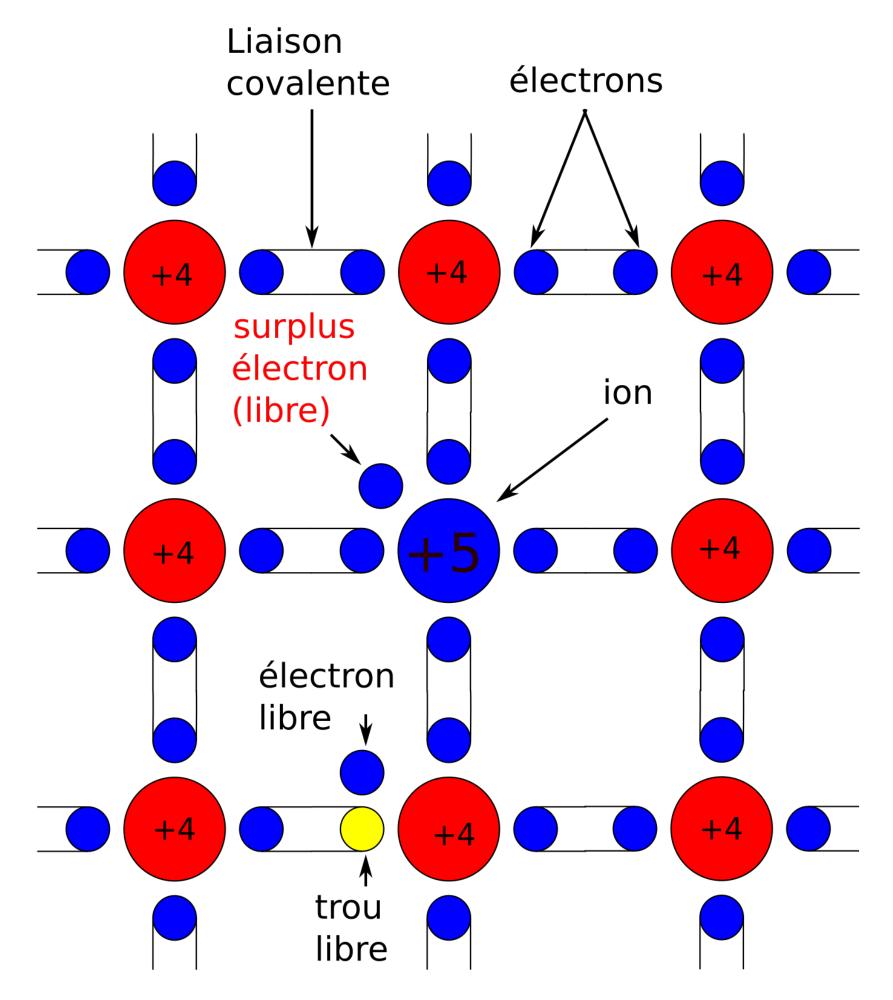


- Communiquer de l'énergie à l'atome par un moyen quelconque (lumière, élévation de la température, etc...)
- Électrons de couche de valence s'en échappent, passent dans la couche de conduction et deviennent **libres**
- Leur départ laisse une charge positive de même valeur absolue appelée **trou**
- Une paire électron-trou libre est née!
- Charges positives et négatives se déplacent et créent un courant électrique dans le cristal
- Nombre de paires électron-trou : 10⁻¹³ par atome (très faible)



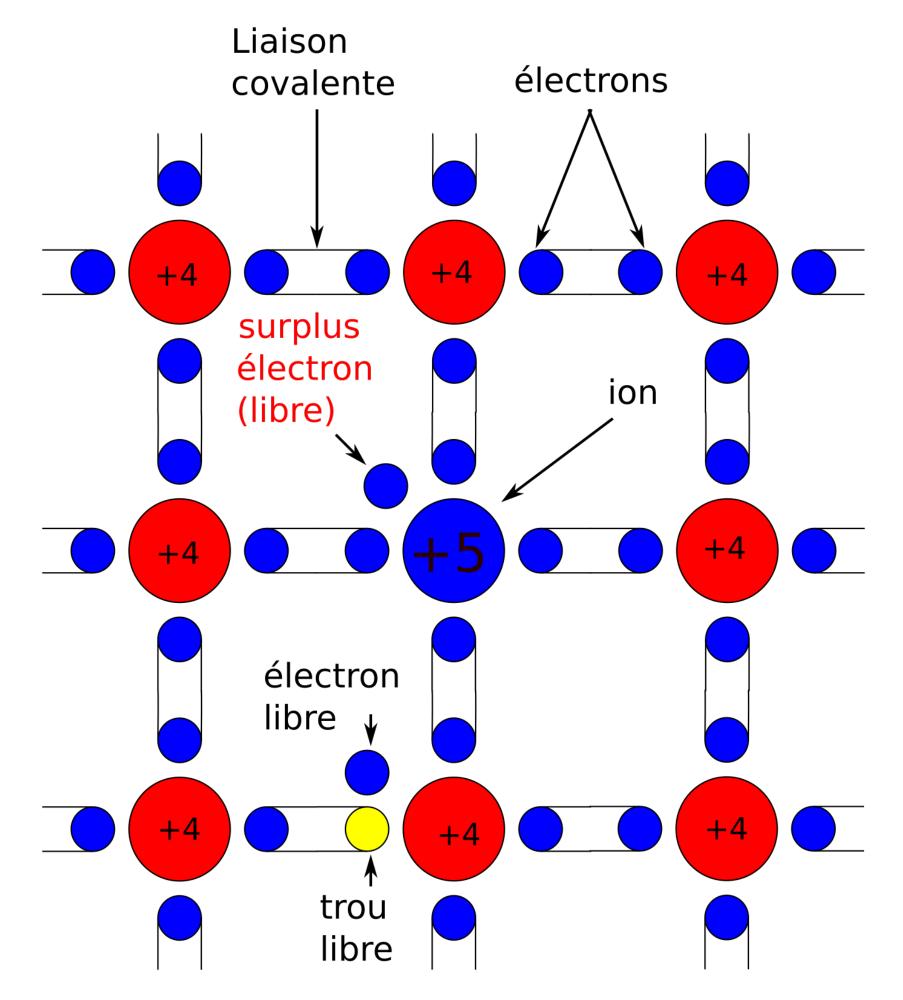


• Injecter un élément de **valence 5** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)



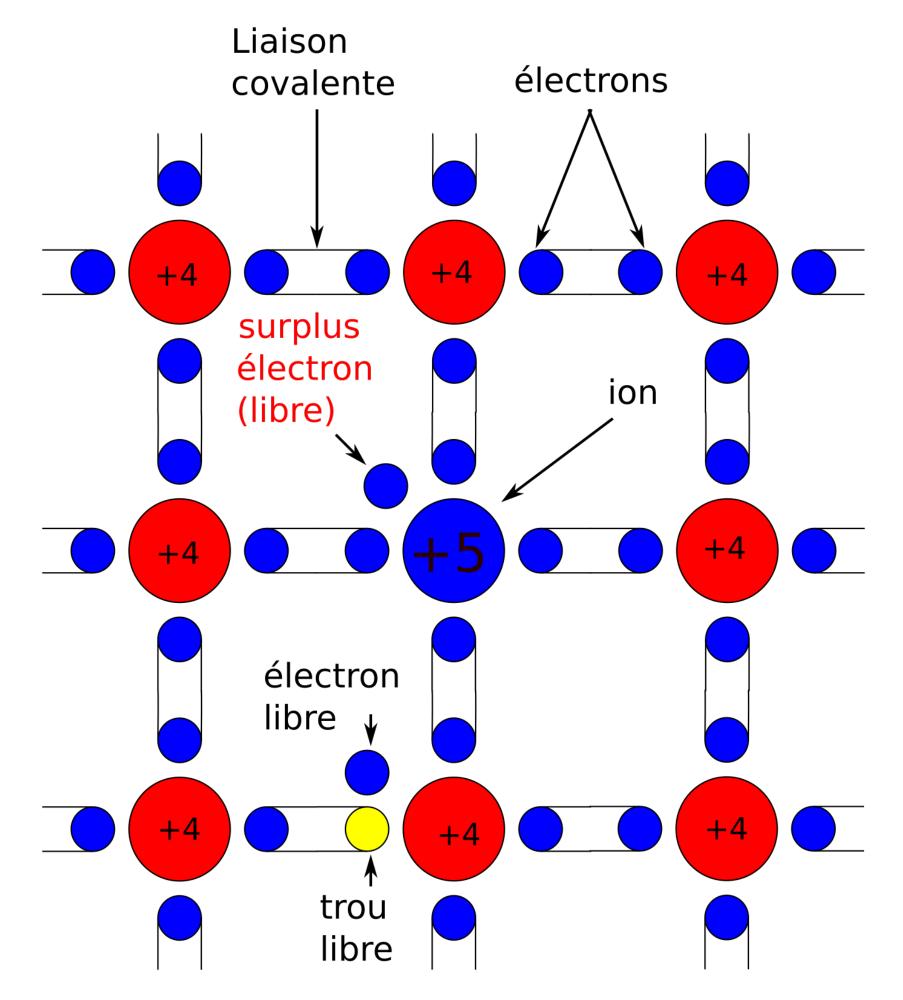


- Injecter un élément de **valence 5** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N





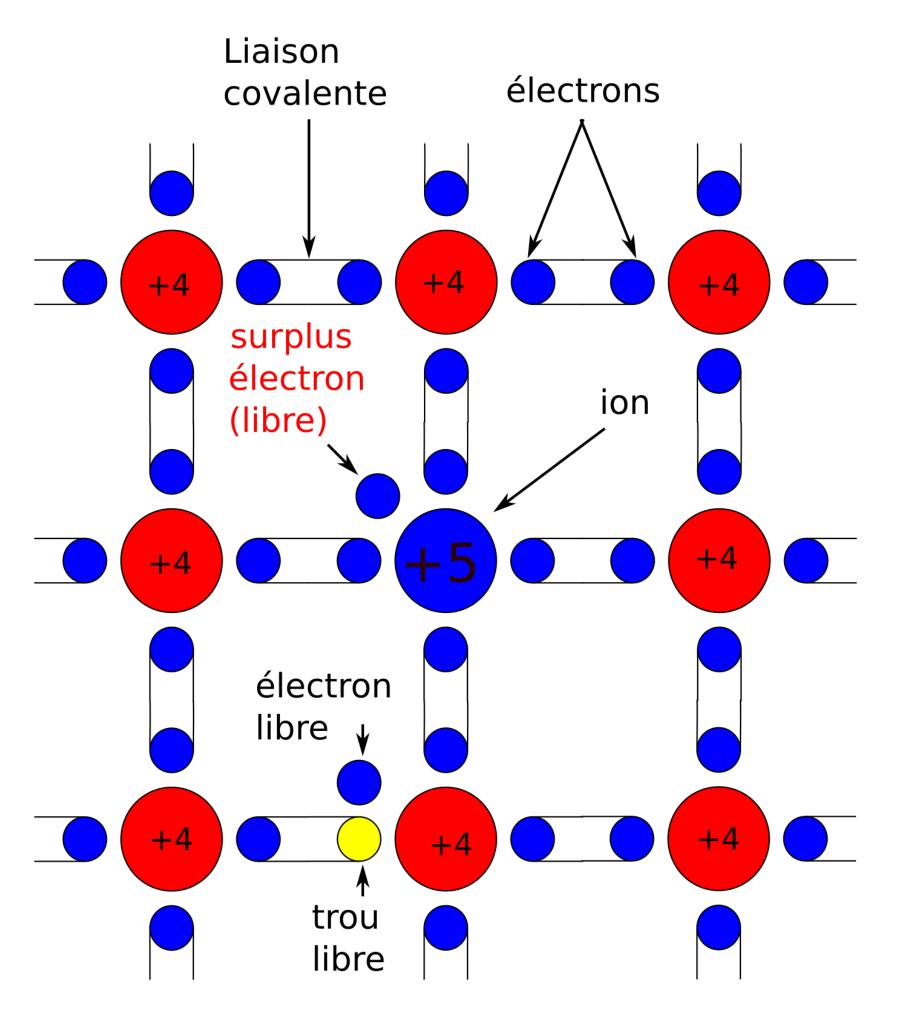
- Injecter un élément de **valence 5** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)



Enseignes et afficheurs à LED | La diode à jonction : principes physiques

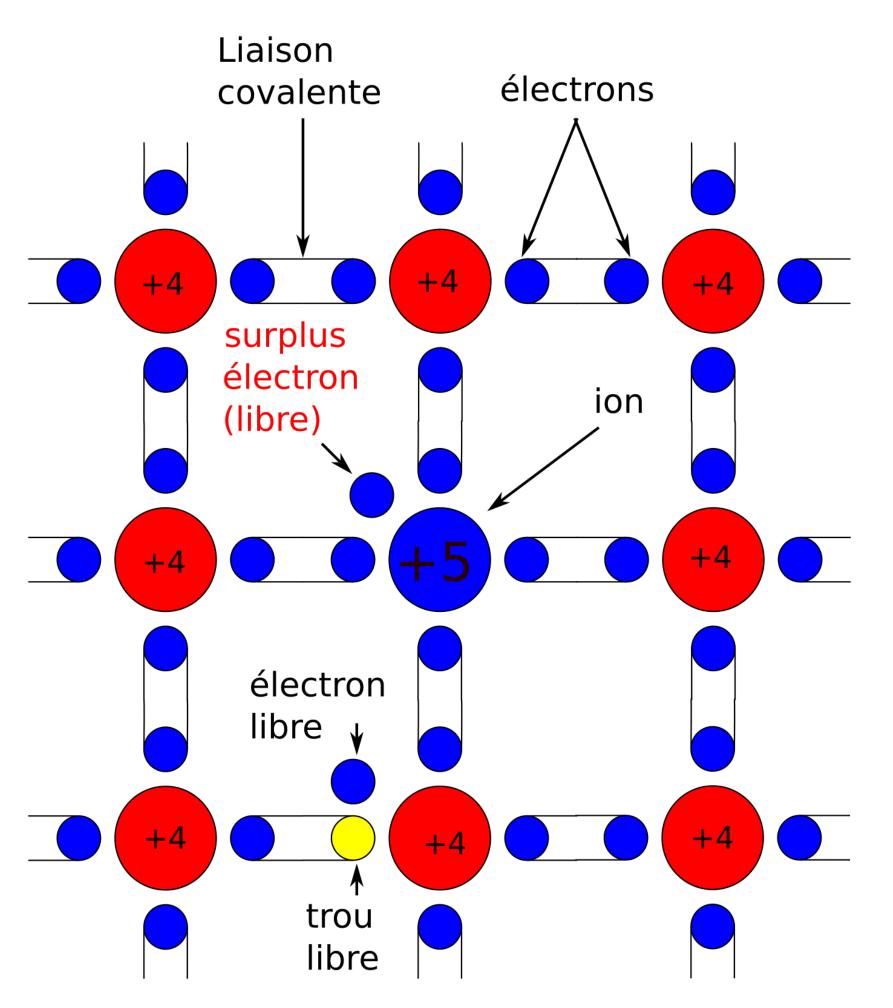


- Injecter un élément de valence 5 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents



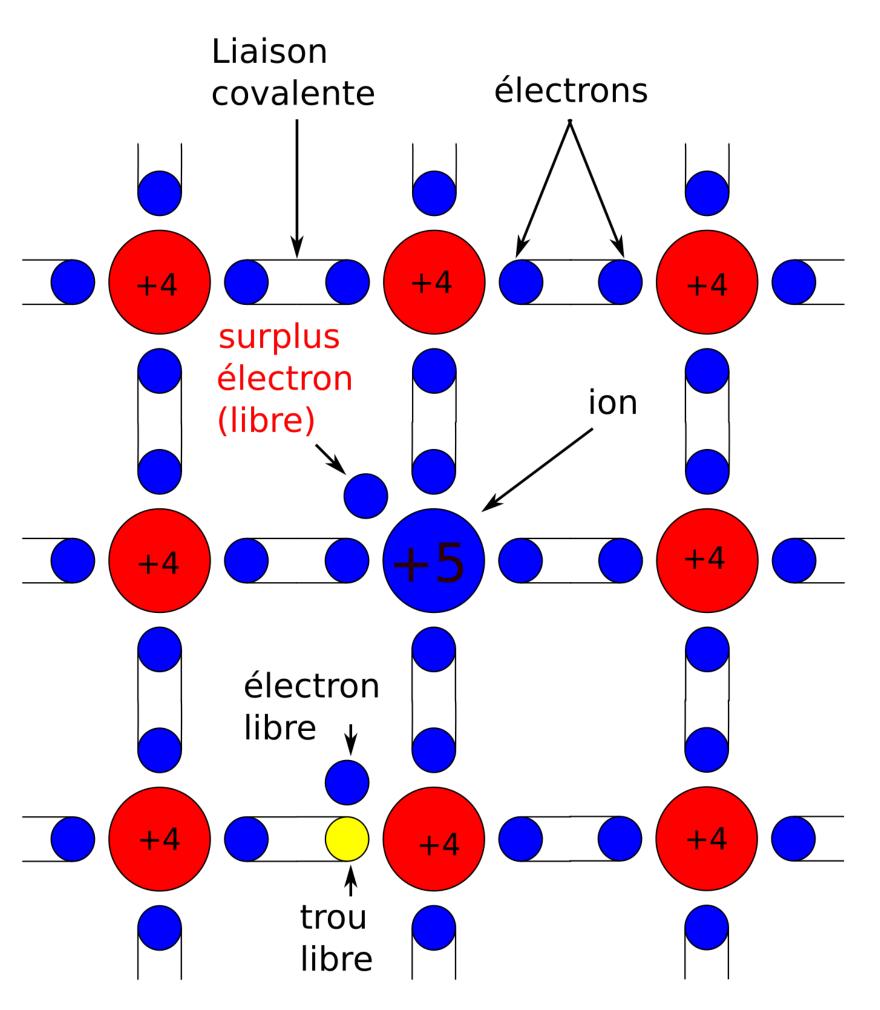


- Injecter un élément de valence 5 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :



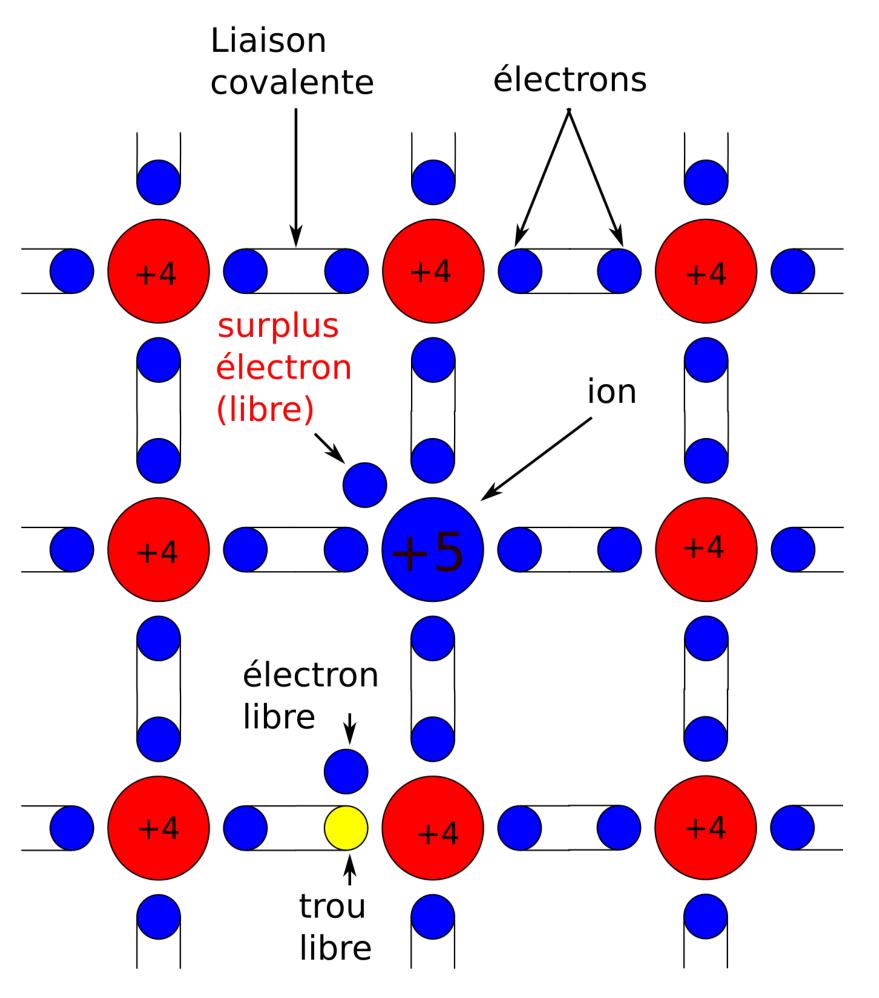


- Injecter un élément de valence 5 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)



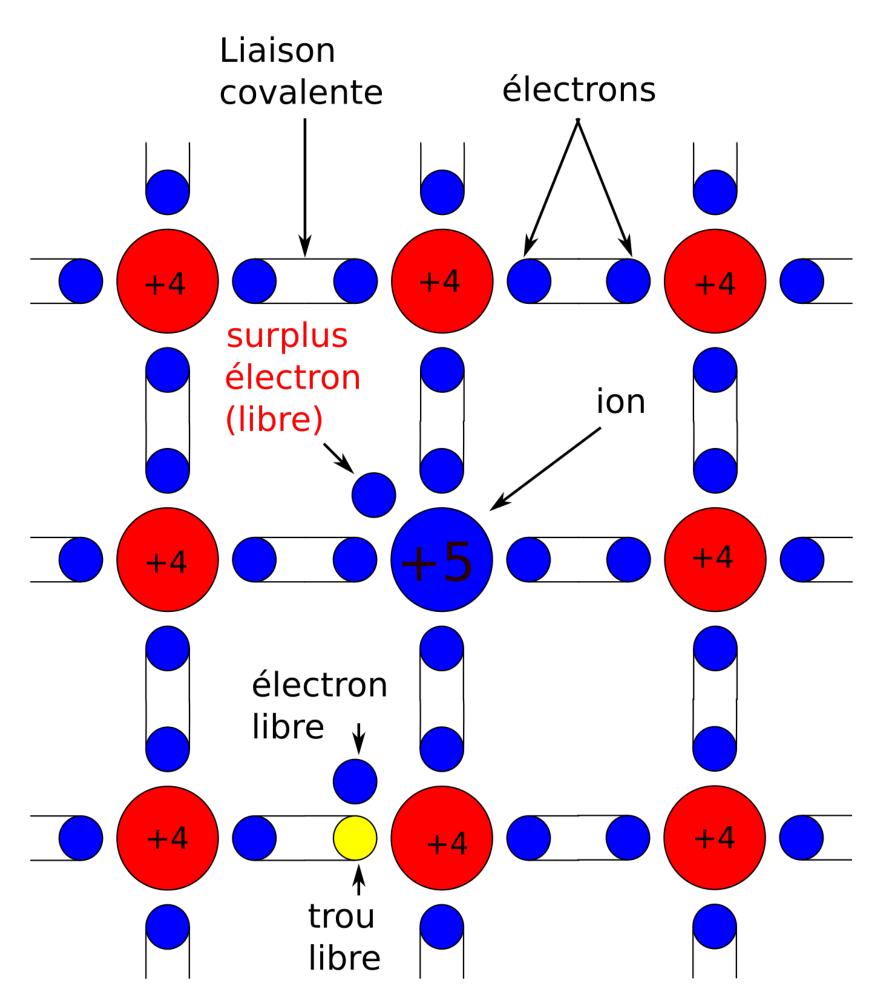


- Injecter un élément de valence 5 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)
 - 10⁻¹³ électrons (conduction intrinsèque)



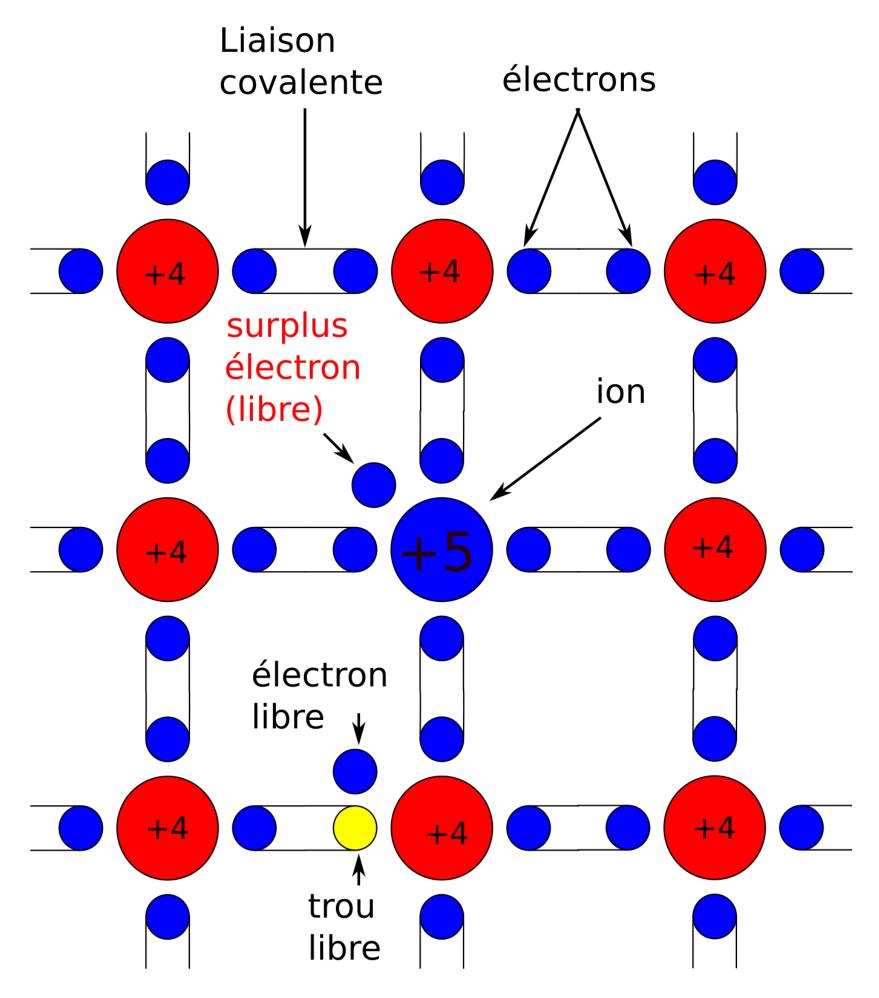


- Injecter un élément de valence 5 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)
 - 10⁻¹³ électrons (conduction intrinsèque)
 - 10⁻⁶ électrons (conduction **extrinsèque**)



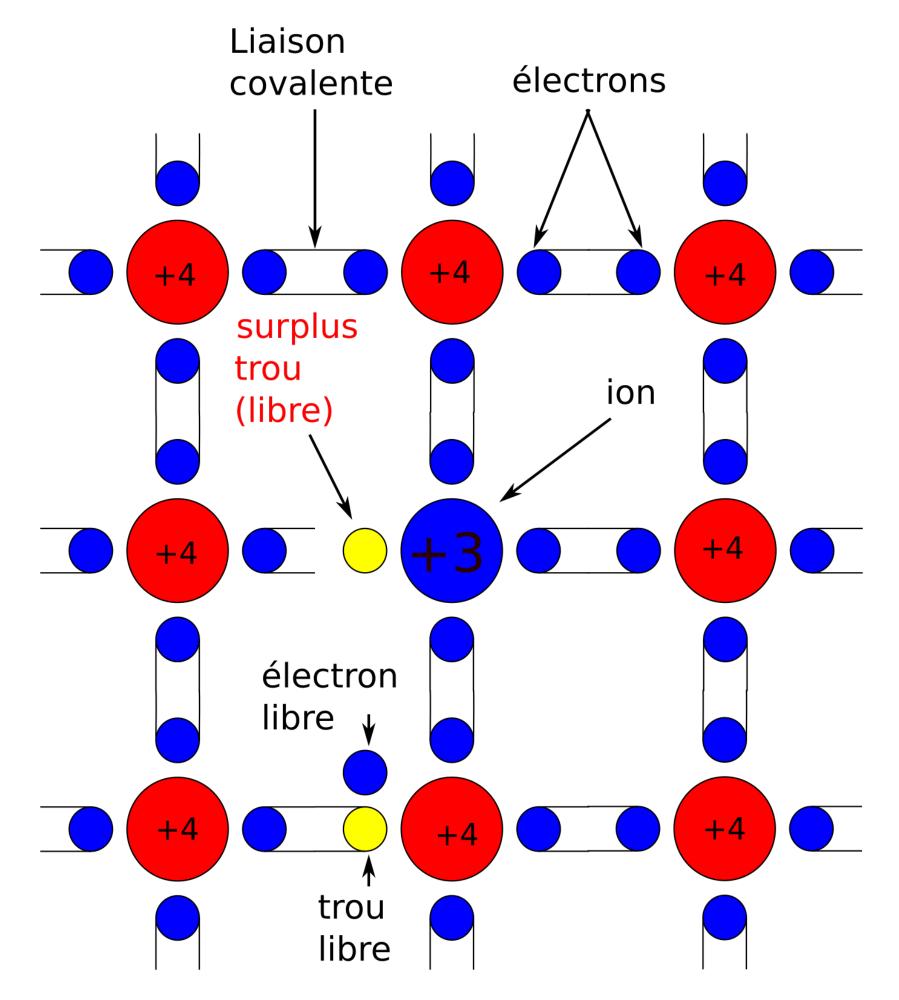


- Injecter un élément de valence 5 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé N
- Surplus d'électrons : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)
 - 10⁻¹³ électrons (conduction intrinsèque)
 - 10⁻⁶ électrons (conduction **extrinsèque**)
- Conduction extrinsèque largement dominante!





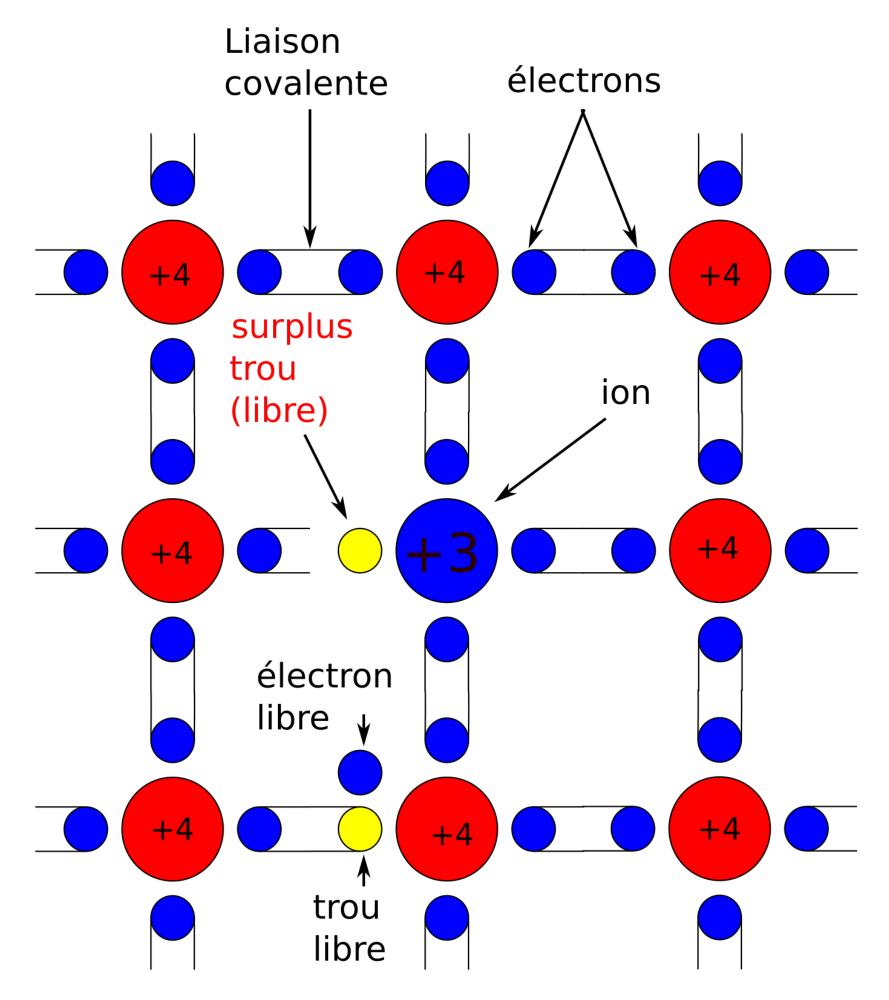
• Injecter un élément de **valence 3** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)



Enseignes et afficheurs à LED | La diode à jonction : principes physiques

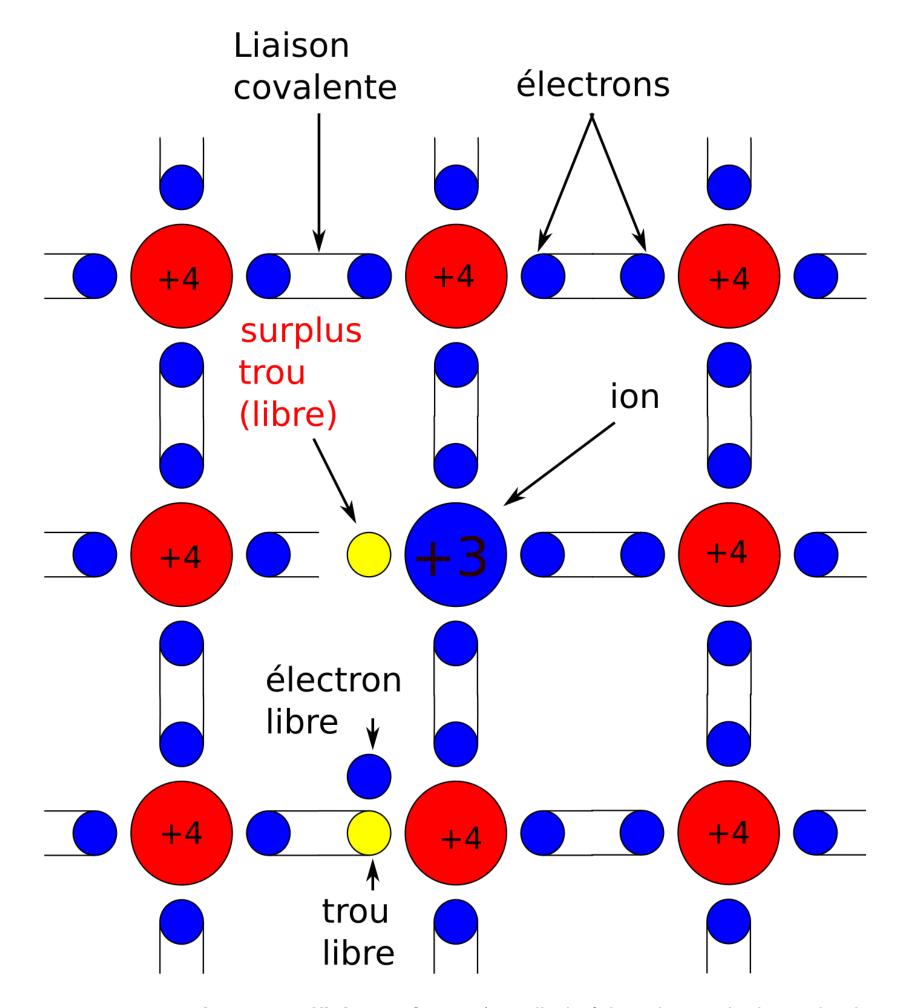


- Injecter un élément de **valence 3** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P





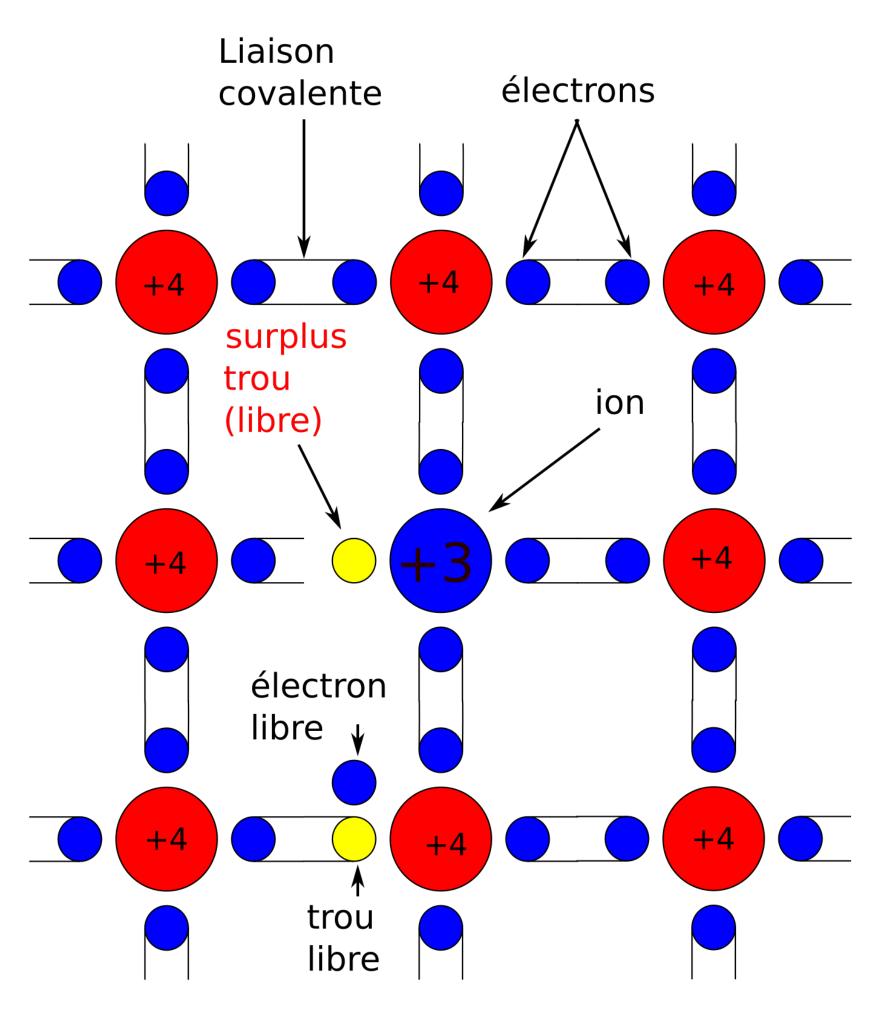
- Injecter un élément de **valence 3** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)



Enseignes et afficheurs à LED | La diode à jonction : principes physiques

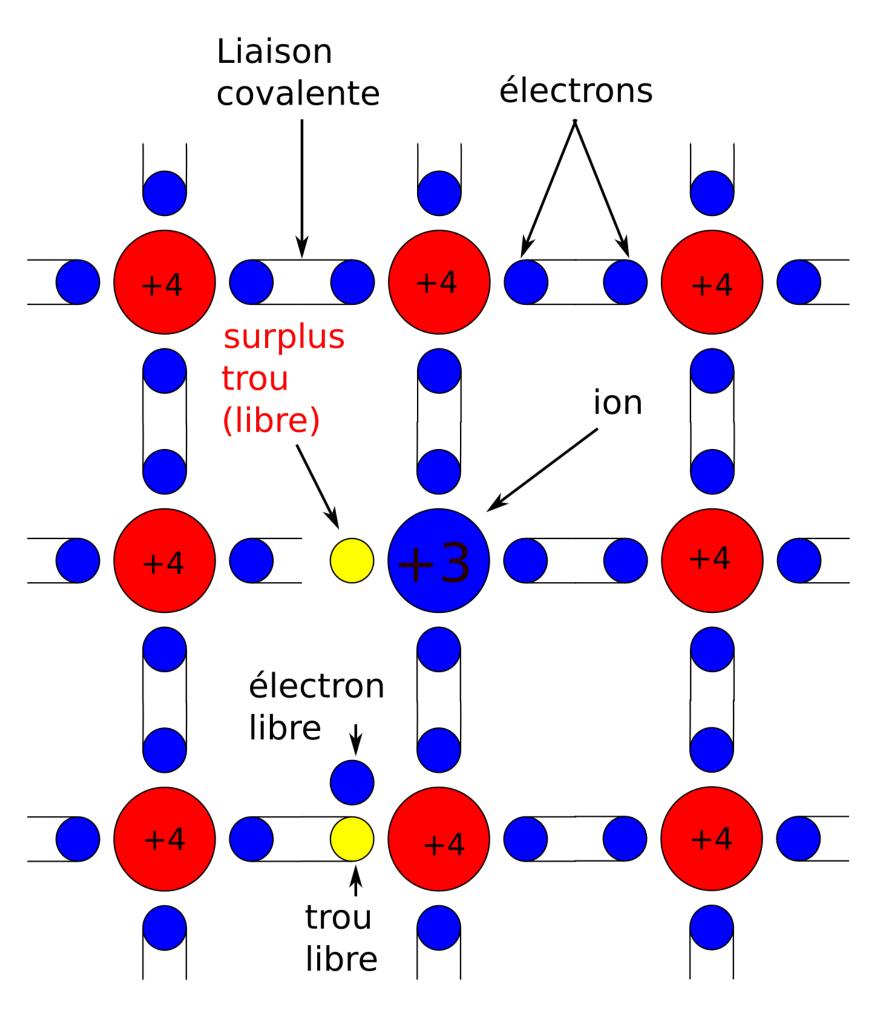


- Injecter un élément de **valence 3** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents



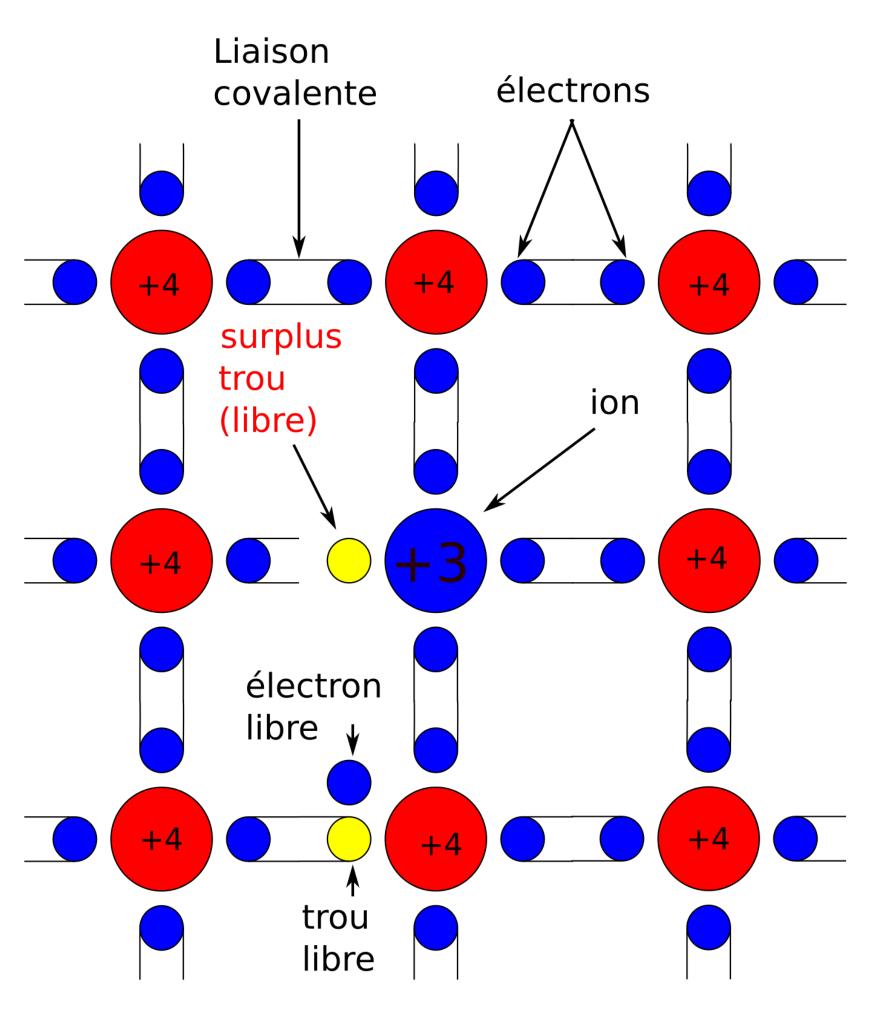


- Injecter un élément de **valence 3** en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :



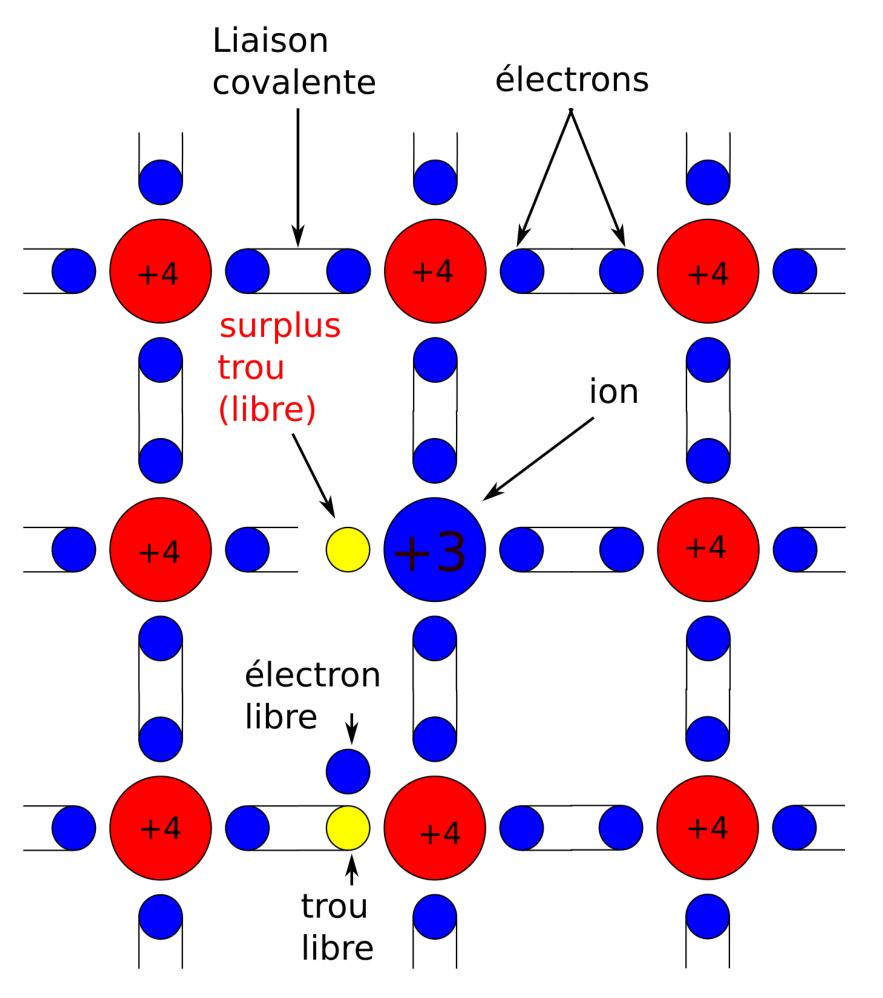


- Injecter un élément de valence 3 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)



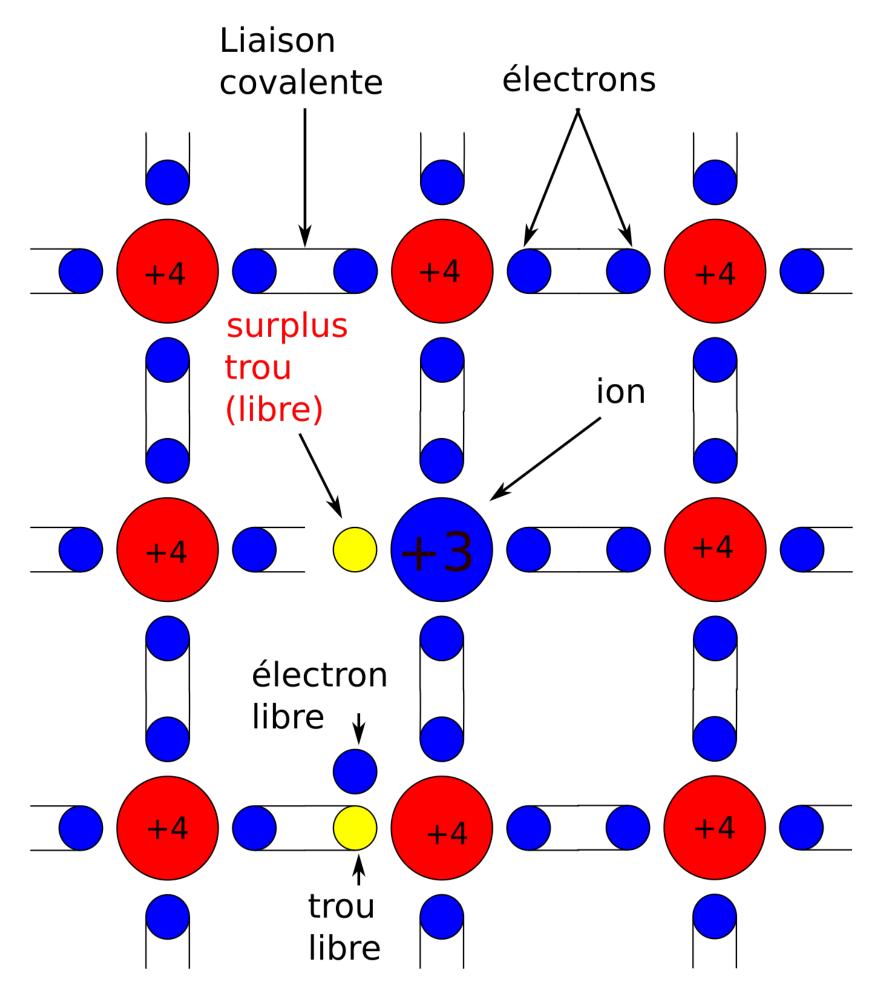


- Injecter un élément de valence 3 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)
 - 10⁻¹³ électrons (conduction intrinsèque)



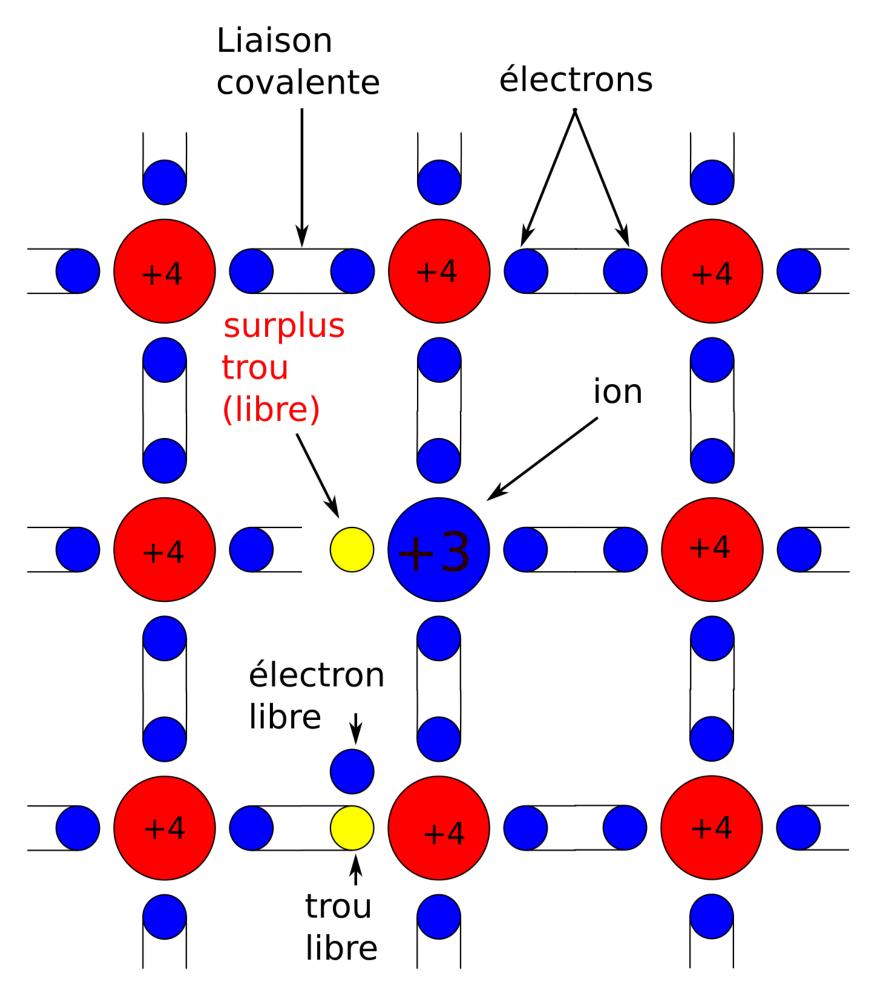


- Injecter un élément de valence 3 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)
 - 10⁻¹³ électrons (conduction intrinsèque)
 - 10⁻⁶ trous (conduction **extrinsèque**)



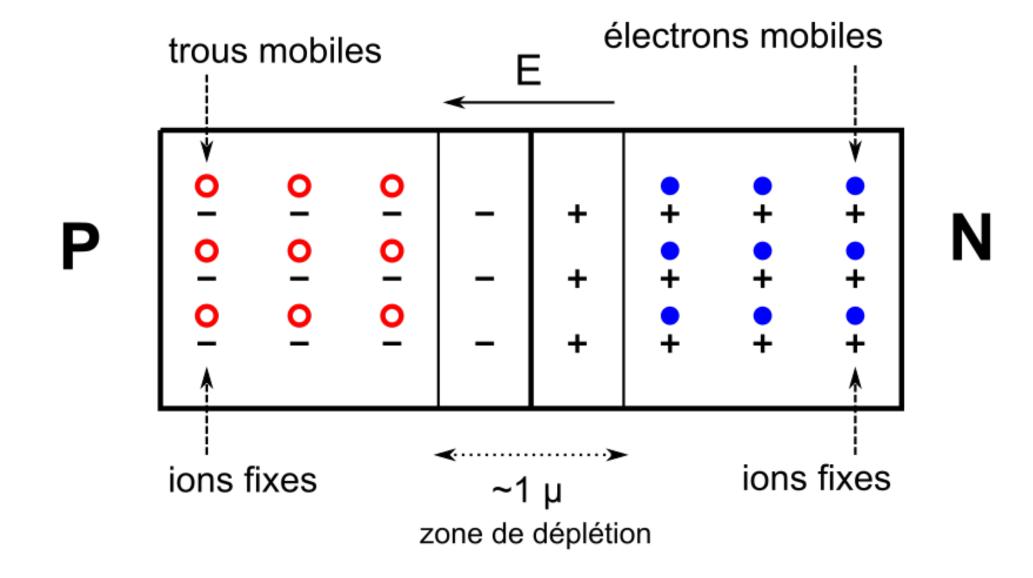


- Injecter un élément de valence 3 en faible quantité (10⁻⁶ par atome)
- Le cristal est dopé P
- Surplus de trous : certains sont d'office libres (10⁻⁶ /atome)
- Paires électron-trou libres également présents
- Conduction dans 1 atome de cristal assurée par :
 - 10⁻¹³ trous (conduction intrinsèque)
 - 10⁻¹³ électrons (conduction intrinsèque)
 - 10⁻⁶ trous (conduction **extrinsèque**)
- Conduction extrinsèque largement dominante!



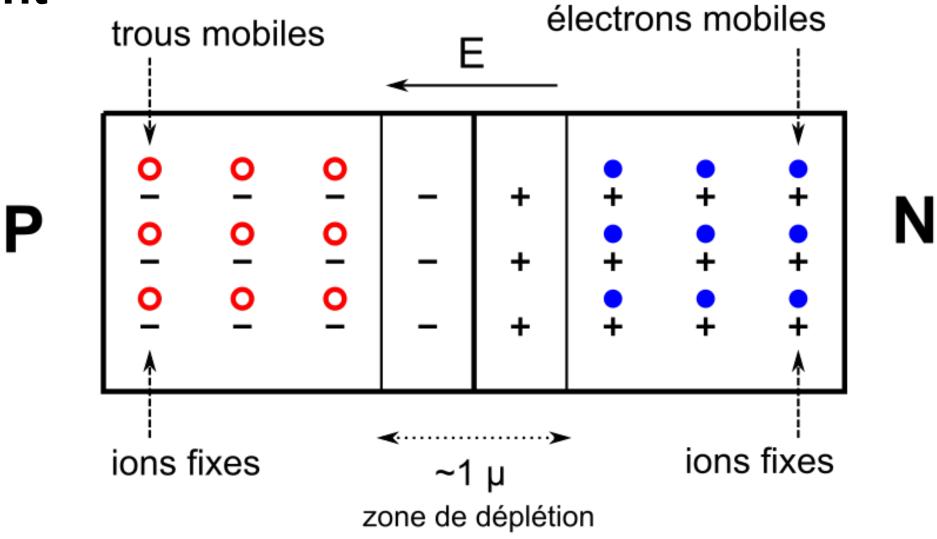


• Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N



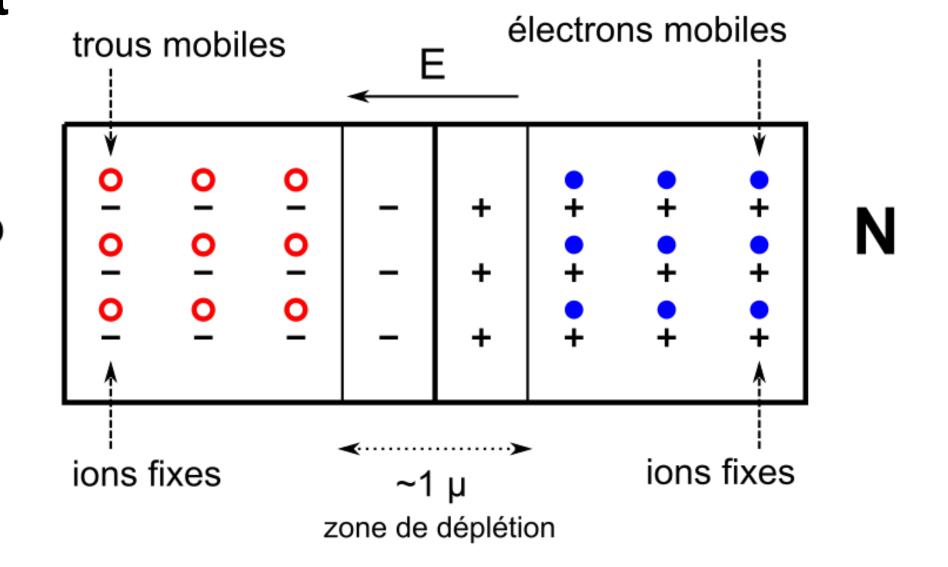


- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent



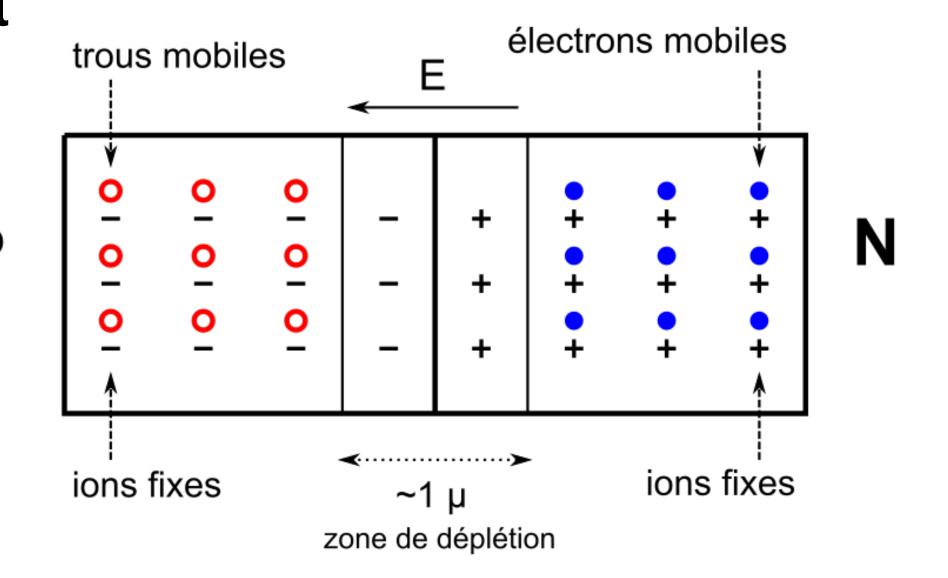


- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent
- Diffusion de porteurs de charges



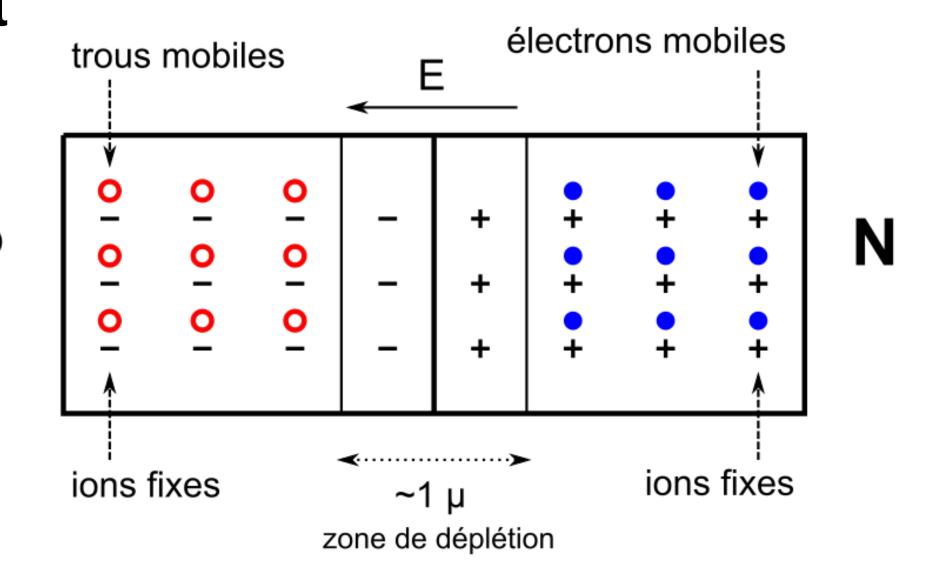


- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent
- **Diffusion** de porteurs de charges
- Neutralisation mutuelle



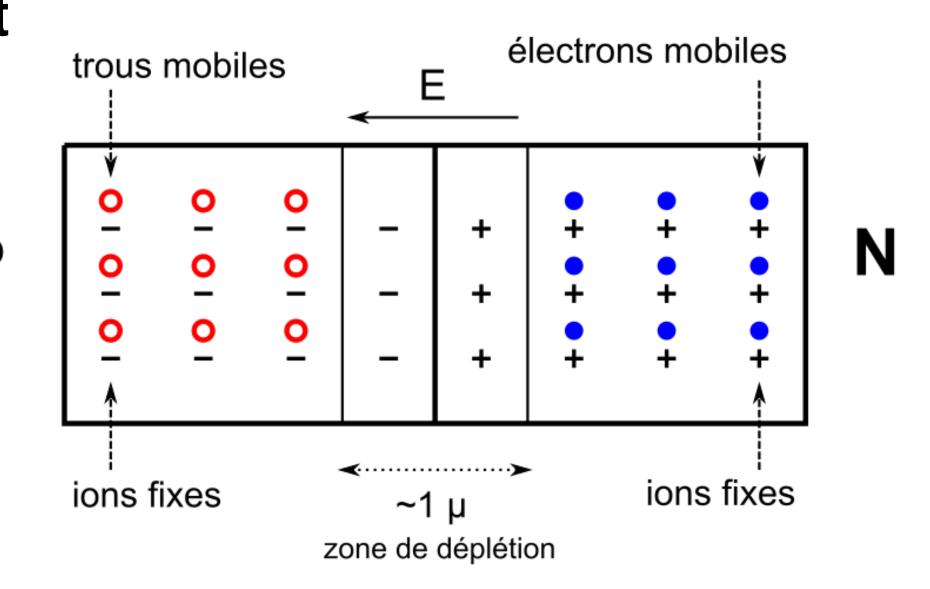


- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent
- Diffusion de porteurs de charges
- Neutralisation mutuelle
- Zones de déplétion



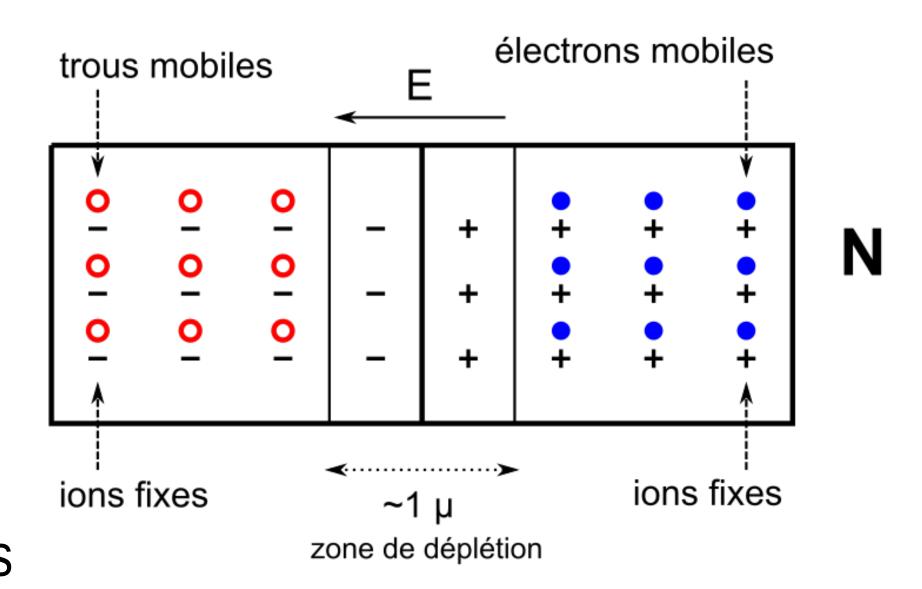


- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent
- Diffusion de porteurs de charges
- Neutralisation mutuelle
- Zones de déplétion
- Champ électrique (barrière de potentiel)



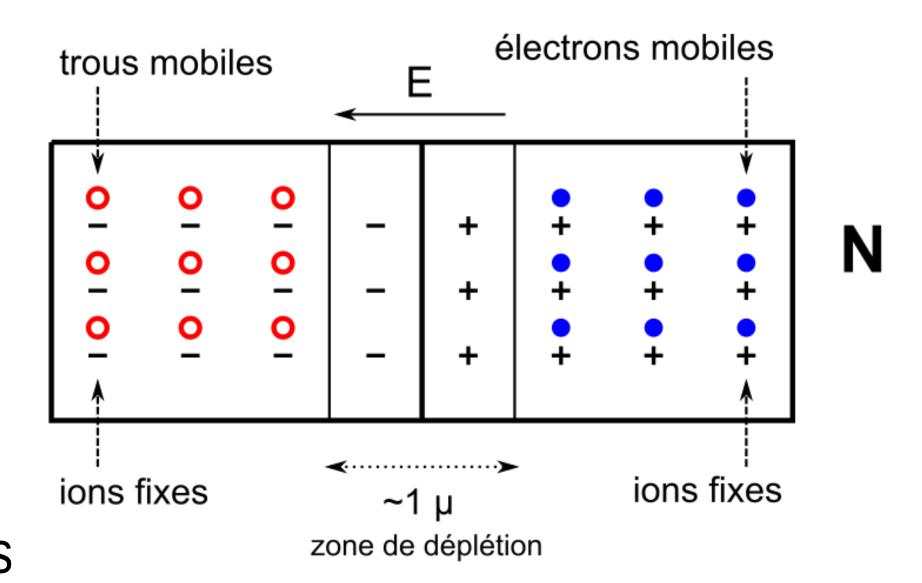


- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent
- Diffusion de porteurs de charges
- Neutralisation mutuelle
- Zones de déplétion
- Champ électrique (barrière de potentiel)
- Champ opposé au passage des porteurs majoritaires





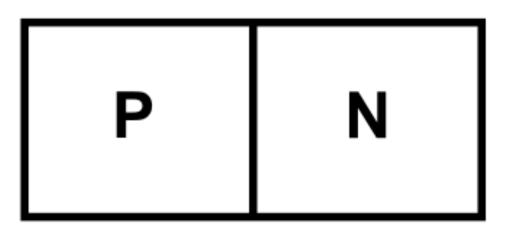
- Mise en contact de semi-conducteurs dopés P et N
- Porteurs de charges de natures différentes s'attirent
- Diffusion de porteurs de charges
- Neutralisation mutuelle
- Zones de déplétion
- Champ électrique (barrière de potentiel)
- Champ opposé au passage des porteurs majoritaires
- MAIS : favorise le passage des porteurs minoritaires

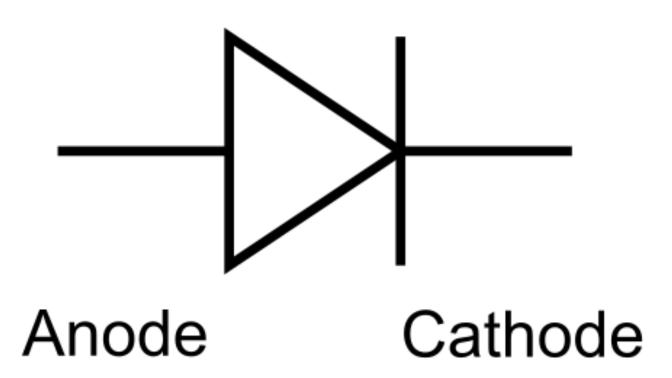


La diode à jonction



 Lorsqu'on soumet la jonction PN à une différence de potentiel, on réalise une diode à jonction





La diode à jonction

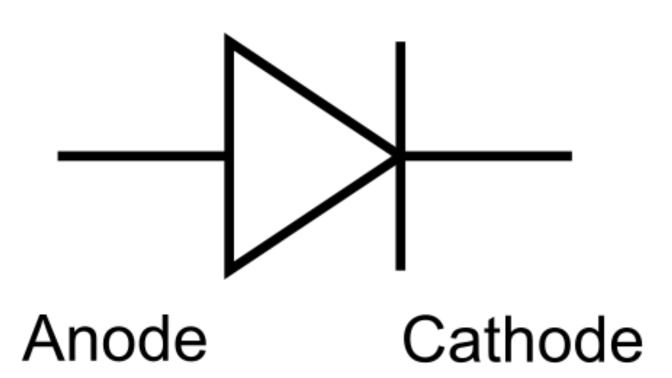


 Lorsqu'on soumet la jonction PN à une différence de potentiel, on réalise une diode à jonction

P

N

Caractéristique de la diode





• Caractéristique c'est la relation entre le courant I=f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes



- Caractéristique c'est la relation entre le courant I = f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes
- Par application à la jonction de :



- Caractéristique c'est la relation entre le courant I = f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes
- Par application à la jonction de :

L'équation fondamentale de la dynamique



- Caractéristique c'est la relation entre le courant I = f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes
- Par application à la jonction de :

L'équation fondamentale de la dynamique

La loi de conservation de l'énergie



- Caractéristique c'est la relation entre le courant I = f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes
- Par application à la jonction de :

L'équation fondamentale de la dynamique

La loi de conservation de l'énergie

La relation
$$E = -grad(V)$$



- Caractéristique c'est la relation entre le courant I = f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes
- Par application à la jonction de :

L'équation fondamentale de la dynamique

La loi de conservation de l'énergie

La relation
$$E = -grad(V)$$

On obtient l'équation différentielle qui régit le courant



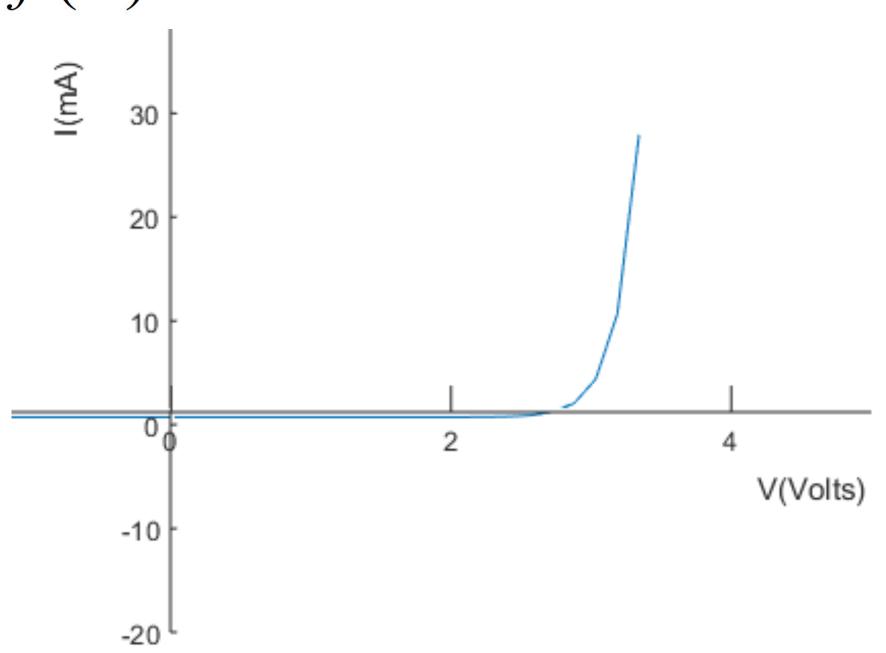
- Caractéristique c'est la relation entre le courant I = f(V) qui traverse la diode et la tension à ses bornes
- Par application à la jonction de :

L'équation fondamentale de la dynamique

La loi de conservation de l'énergie

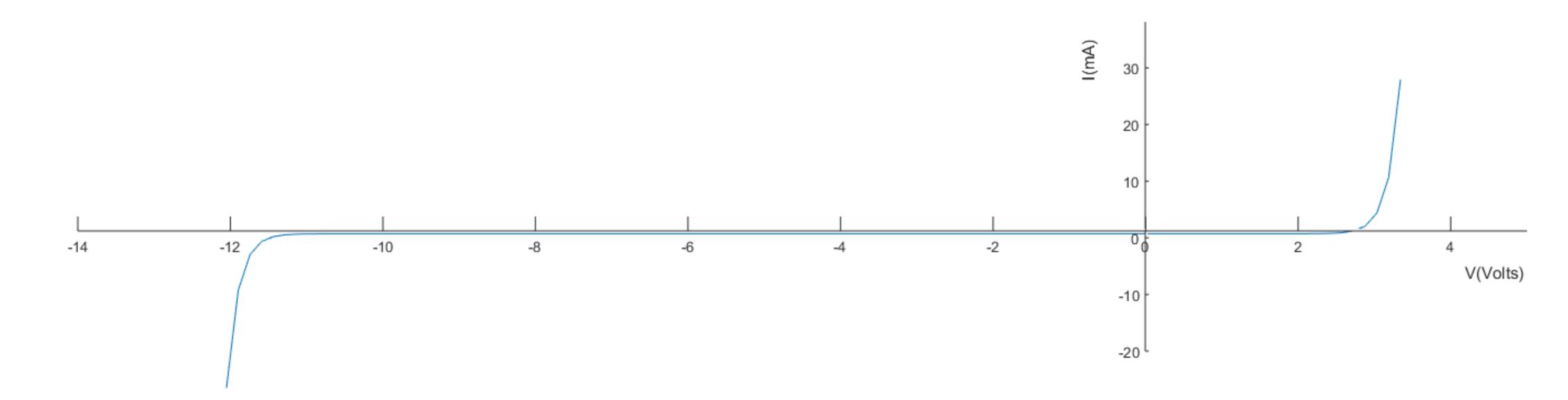
La relation E = -grad(V)

- On obtient l'équation différentielle qui régit le courant
- La résolution de l'équation donne : $I = I_s(e^{\eta kT} 1)$



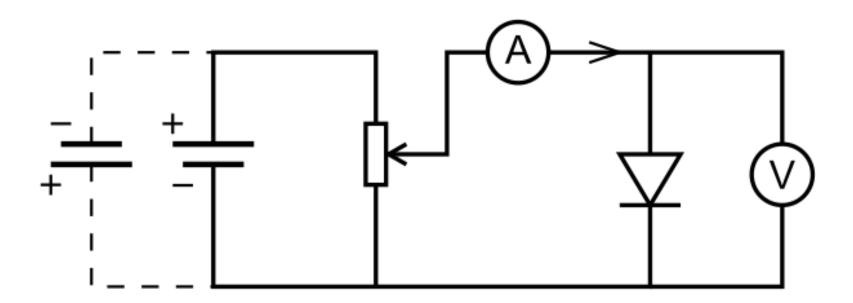


Avec la partie négative :



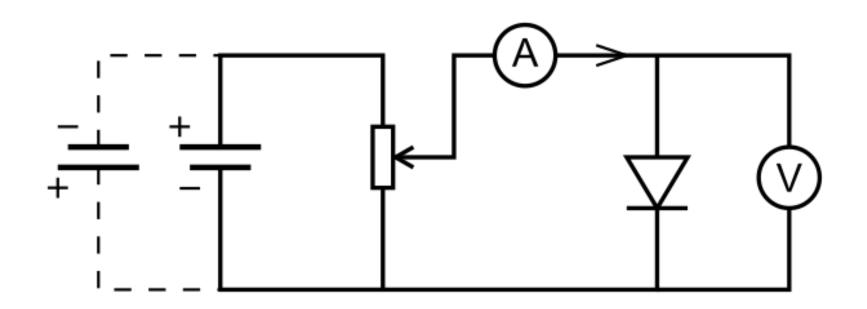


• Réaliser le circuit ci-contre :



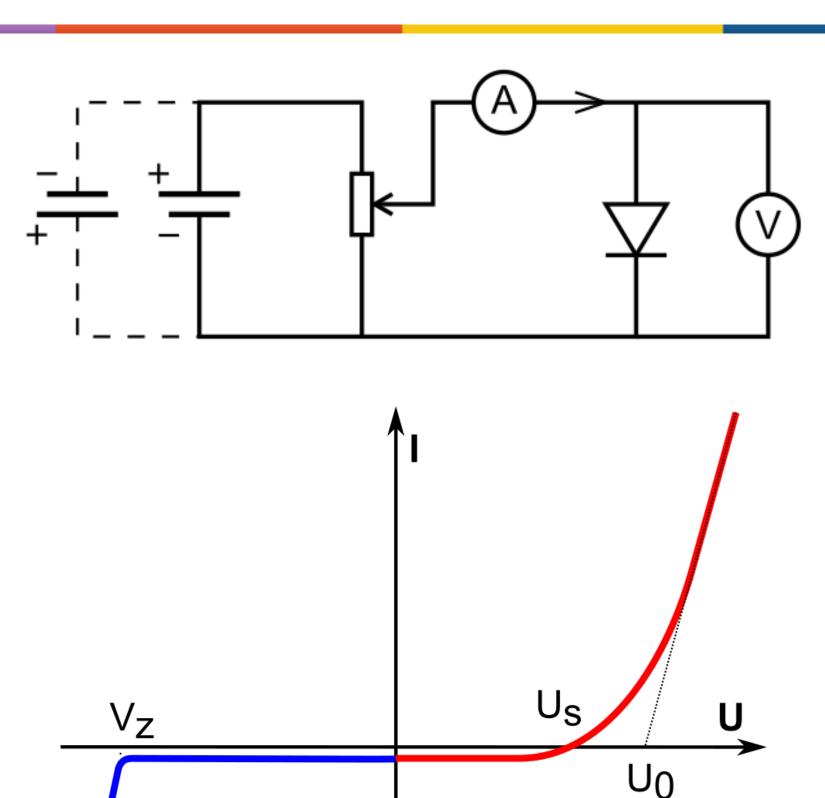


- Réaliser le circuit ci-contre :
- Relever dans un tableau la valeur de I pour chaque valeur de U



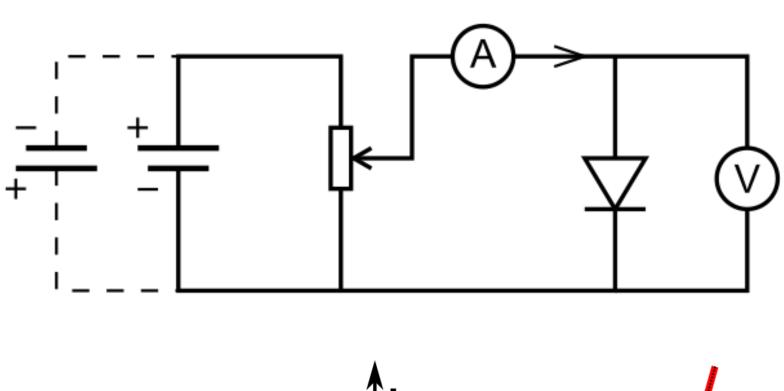


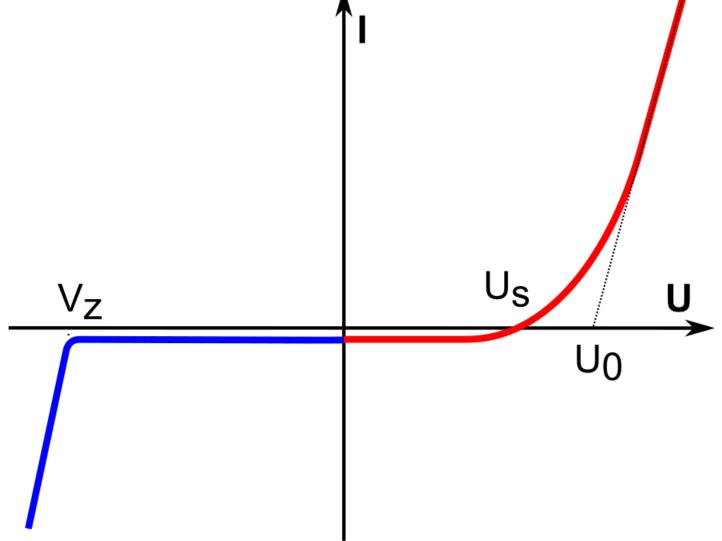
- Réaliser le circuit ci-contre :
- Relever dans un tableau la valeur de I pour chaque valeur de U
- Tracer





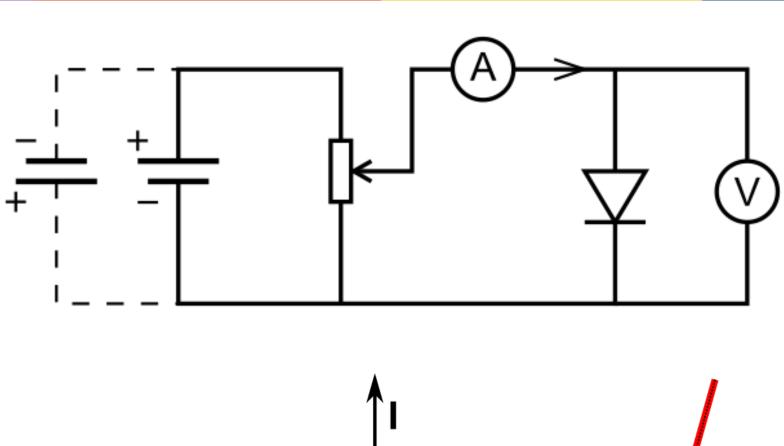
- Réaliser le circuit ci-contre :
- Relever dans un tableau la valeur de I pour chaque valeur de U
- Tracer
- Commentaires :

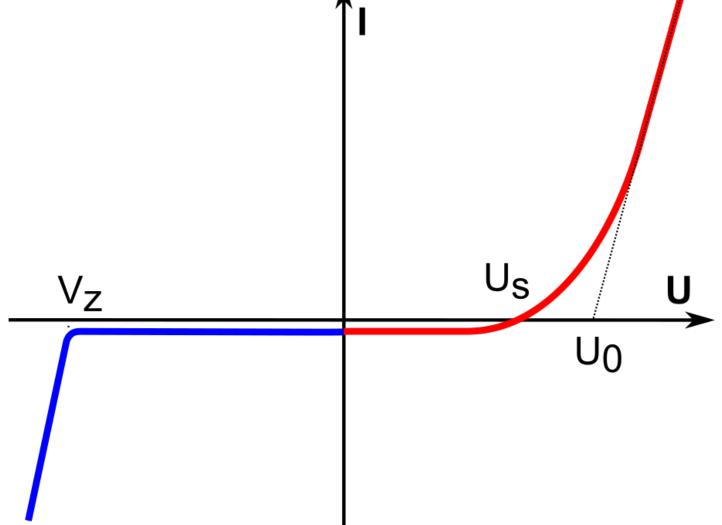






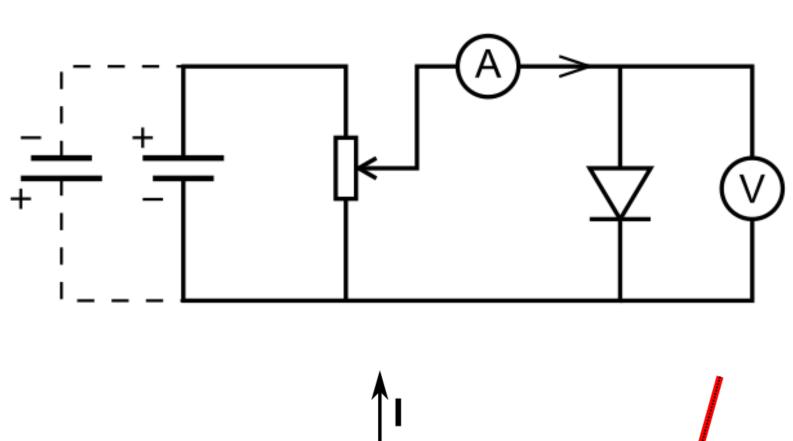
- Réaliser le circuit ci-contre :
- Relever dans un tableau la valeur de I pour chaque valeur de U
- Tracer
- Commentaires :
 - Allure semblable à celle de la courbe théorique

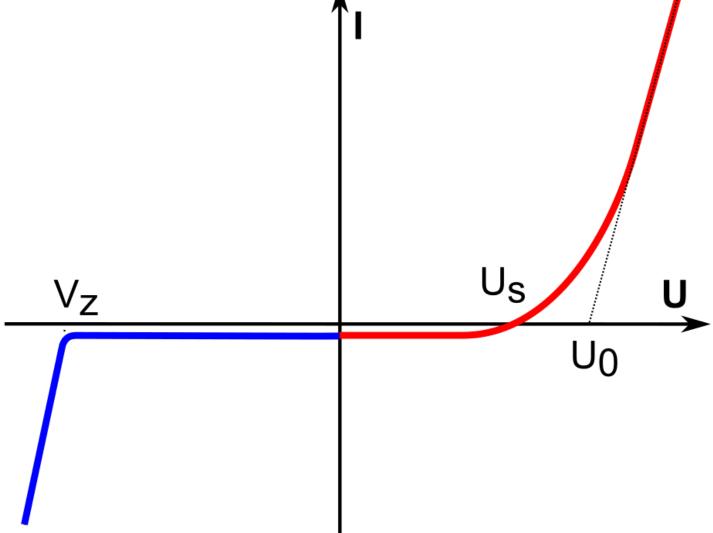






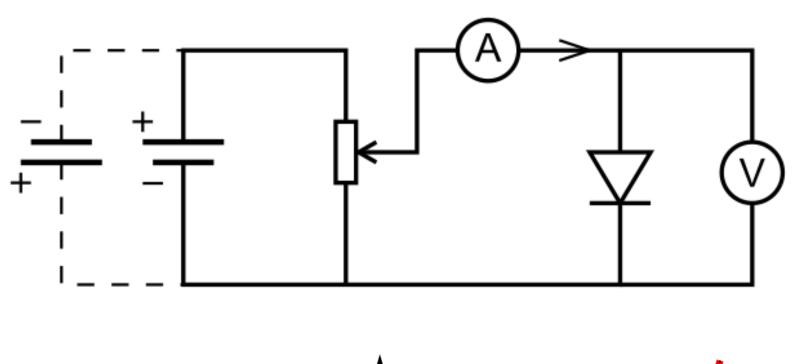
- Réaliser le circuit ci-contre :
- Relever dans un tableau la valeur de I pour chaque valeur de U
- Tracer
- Commentaires :
 - Allure semblable à celle de la courbe théorique
 - Points particuliers: Vz, Us, Uo

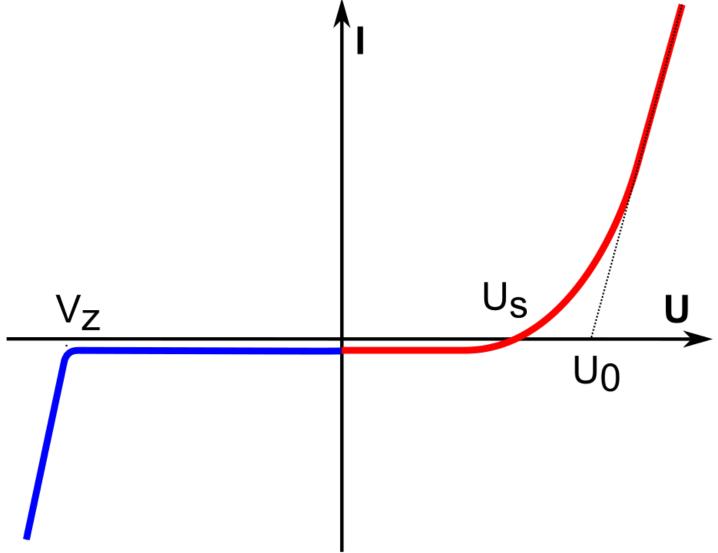






- Réaliser le circuit ci-contre :
- Relever dans un tableau la valeur de I pour chaque valeur de U
- Tracer
- Commentaires :
 - Allure semblable à celle de la courbe théorique
 - Points particuliers: Vz, Us, Uo
 - Notions de Passante et Non passante





La diode à jonction : principes physiques



- Modèle de Bohr
- Niveaux d'énergie
- Semi-conducteurs intrinsèques
- Dopage N et P
- Jonction PN
- La diode à jonction